

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 9 月 2 4 日
Date of Application:

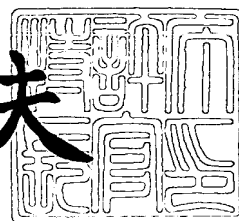
出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 7 7 6 2 4
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 7 7 6 2 4]

出 願 人 ニ ッ タ 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 8 月 1 5 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出 証 番 号 出 証 特 2 0 0 3 - 3 0 6 6 7 7 2

【書類名】 特許願

【整理番号】 20924027

【提出日】 平成14年 9月24日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G01L 5/00

【発明の名称】 センサシート

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 奈良県大和郡山市池沢町 1 7 2 番地 ニッタ株式会社奈良工場内

【氏名】 森本 英夫

【特許出願人】

【識別番号】 000111085

【氏名又は名称】 ニッタ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100089196

【弁理士】

【氏名又は名称】 梶 良之

【選任した代理人】

【識別番号】 100104226

【弁理士】

【氏名又は名称】 須原 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014731

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9407223

【包括委任状番号】 0000300

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 センサシート

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 外部から加えられる力について互いに異なる複数方向に対応する成分をそれぞれ認識可能である複数のセンサが実質的に同一面上に配置されていることを特徴とするセンサシート。

【請求項 2】 前記センサが、
前記複数方向にそれぞれ対応する複数種類の第 1 の電極と、
前記第 1 の電極と対向するように配置されており前記第 1 の電極との間でそれぞれ容量素子を構成すると共に、外部から加えられる力に伴って前記第 1 の電極と近接する方向に変位可能な第 2 の電極とを備えており、
前記第 1 の電極に対して入力される信号を利用して前記第 1 の電極と前記第 2 の電極との間隔の変化に起因する前記容量素子の静電容量値の変化がそれぞれ検出されることに基づいて外部から加えられた力を認識可能な静電容量式センサであることを特徴とする請求項 1 に記載のセンサシート。

【請求項 3】 前記第 1 の電極に隣接するように配置された第 3 の電極をさらに備えており、
前記第 2 の電極が絶縁状態に維持されていると共に、前記第 3 の電極は接地されており、
外部から力が加えられる場合に、前記第 2 の電極と前記第 3 の電極とが接触可能に設けられていることを特徴とする請求項 2 に記載のセンサシート。

【請求項 4】 前記センサが、
前記複数方向にそれぞれ対応する複数種類の第 1 の電極と、
前記第 1 の電極と対向するように配置されており、外部から加えられる力に伴って前記第 1 の電極と近接する方向に変位可能な第 2 の電極と、
前記第 1 の電極と前記第 2 の電極との間に配置された感圧抵抗体とを備えており、
前記第 1 の電極と前記第 2 の電極との間の抵抗値の変化が検出されることに基づいて外部から加えられた力を認識可能な抵抗型センサであることを特徴とする

請求項 1 に記載のセンサシート。

【請求項 5】 前記センサが、

外部から加えられる力によって前記第 2 の電極を変位させるための硬質の材料で形成されたコア部材をさらに備えていることを特徴とする請求項 2 ～ 4 のいずれか 1 項に記載のセンサシート。

【請求項 6】 前記センサがマトリックス状に配置されていることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載のセンサシート。

【請求項 7】 外部から加えられる力を受ける面が実質的に凹凸がないように構成されていることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載のセンサシート。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、外部から加えられる力の分布の測定を行うために用いて好適なセンサシートに関する。

【0002】

【従来の技術】

センサシートは、外部から加えられた力の分布を測定可能なものであって、例えば歩行解析などに利用されている。センサシートとしては、感圧抵抗インクが縦方向に沿う帯状に印刷された P E T フィルムと、感圧抵抗インクが横方向（縦方向と直交する方向）に沿う帯状に印刷された P E T フィルムとが、それぞれに印刷された感圧抵抗インクが交差するように貼り合わされたものが知られている（特許文献 1、2 参照）。かかるセンサシートでは、外部から力が加えられた場合には、力が加えられた部分に対応する 2 枚の P E T フィルム間の接触抵抗が変化する。従って、多数の感圧抵抗インクのラインに沿った接触抵抗の大きさの時間的な変化を検出することによって、外部から加えられた力（圧力）の分布を測定することができる。

【0003】

【特許文献 1】

米国特許第 4, 7 3 4, 0 3 4 号明細書

【特許文献 2】

米国特許第 4, 8 5 6, 9 9 3 号明細書

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、かかるセンサシートでは、外部から加えられる力の当該シートに垂直な方向の 1 次元の力の分布しか測定することができない。従って、センサシートに対して斜め方向（垂直方向でない方向）の力が加えられた場合でも、その斜め方向の力の当該シートに垂直な方向成分の大きさの力が加えられた場合と同様の力の分布しか得られないため、外部から加えられる力の分布の詳細な解析を行うことができない。

【0 0 0 5】

そこで、本発明の目的は、多次元の力の分布を測定可能なセンサシートを提供することである。

【0 0 0 6】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、請求項 1 のセンサシートは、外部から加えられる力について互いに異なる複数方向に対応する成分をそれぞれ認識可能である複数のセンサが実質的に同一面上に配置されていることを特徴とするものである。

【0 0 0 7】

請求項 2 のセンサシートは、前記センサが、前記複数方向にそれぞれ対応する複数種類の第 1 の電極と、前記第 1 の電極と対向するように配置されており前記第 1 の電極との間でそれぞれ容量素子を構成すると共に、外部から加えられる力に伴って前記第 1 の電極と近接する方向に変位可能な第 2 の電極とを備えており、前記第 1 の電極に対して入力される信号を利用して前記第 1 の電極と前記第 2 の電極との間隔の変化に起因する前記容量素子の静電容量値の変化がそれぞれ検出されることに基づいて外部から加えられた力を認識可能な静電容量式センサであることを特徴とするものである。

【0 0 0 8】

請求項4のセンサシートは、前記センサが、前記複数方向にそれぞれ対応する複数種類の第1の電極と、前記第1の電極と対向するように配置されており、外部から加えられる力に伴って前記第1の電極と近接する方向に変位可能な第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極との間に配置された感圧抵抗体とを備えており、前記第1の電極と前記第2の電極との間の抵抗値の変化が検出されることに基づいて外部から加えられた力を認識可能な抵抗型センサであることを特徴とするものである。

【0009】

請求項1、2、4によると、センサが外部から加えられた力の複数方向成分をそれぞれ認識することができるため、センサシート全体において、外部から加えられた力の検知面に垂直方向成分だけでなく、その他の方向成分を含む多次元の力の分布を測定することができる。従って、センサシートに作用する力の詳細な解析を行うことが可能となる。

【0010】

請求項3のセンサシートは、前記第1の電極に隣接するように配置された第3の電極をさらに備えており、前記第2の電極が絶縁状態に維持されていると共に、前記第3の電極は接地されており、外部から力が加えられる場合に、前記第2の電極と前記第3の電極とが接触可能に設けられていることを特徴とするものである。

【0011】

請求項3によると、外部から力が加えられていない場合には、第2の電極が絶縁状態に維持されているため、第1の電極と第2の電極との間に構成される容量素子には電圧がかからない。そのため、当該容量素子に蓄えられている電荷量が無視できる程度に小さくなり、センサからの出力信号は一定の大きさに安定している。一方、外部から力が加えられると、第2の電極が接地された第3の電極と接触するため、当該容量素子に電圧がかかるようになる。そのため、当該容量素子に蓄えられている電荷量が急激に大きくなり、センサからの出力信号が当該容量素子の静電容量値の変化に応じて大きく変化する。このように、外部から力が加えられる前およびその後における当該容量素子に蓄えられている電荷量は、外

部から力が加えられている間の電荷量と比較すると、いずれも無視できる程度に小さい。そのため、第 2 の電極の復帰位置が元の位置からずれた場合でも、外部から力が加えられる前およびその後におけるセンサの各容量素子に対応する（各容量素子用電極からの）出力信号はほとんど同じになる。これにより、センサの各容量素子に対応する出力信号のヒステリシスを低減することができる。

【 0 0 1 2 】

また、第 2 の電極と第 3 の電極とが互いに接触する状態および接触しない状態のいずれかの状態を取りうるスイッチとして機能するため、外部から力が加えられていないセンサの第 2 の電極が、当該センサに近接するその他のセンサに対して外部から加えられた力によって若干（当該センサの第 2 の電極と第 3 の電極とが接触しない程度に）変位した場合でも、当該センサの出力が変化することがない。従って、当該センサに近接するその他のセンサに加えられる力によって、当該センサに測定誤差が生じて、力の分布の測定精度が著しく低下するのを抑制することができる。つまり、複数のセンサが互いに近接するように配置されている場合でも、所定の大きさ（第 2 の電極と第 3 の電極とを接触させる程度の大きさ）以上の力が加えられたセンサだけが力覚センサとして機能することになる。

【 0 0 1 3 】

請求項 5 のセンサシートは、前記センサが、外部から加えられる力によって前記第 2 の電極を変位させるための硬質の材料で形成されたコア部材をさらに備えていることを特徴とするものである。

【 0 0 1 4 】

請求項 5 によると、外部から加えられた力を第 2 の電極に効率よく伝達することができる。特に、外部から力が加えられたときの第 2 の電極の傾き（第 2 の電極の一端部の変位と他端部の変位との差）を利用して当該力が検出される場合に、第 2 の電極の傾きが検出し易くなって、センサにおける検出精度を向上させることができる。

【 0 0 1 5 】

請求項 6 のセンサシートは、前記センサがマトリックス状に配置されていることを特徴とするものである。

【0016】

請求項6によると、センサがセンサシート全体に均一に配置されるため、センサシート上に対して外部から加えられた力の分布を精度よく検出することができる。

【0017】

請求項7のセンサシートは、外部から加えられる力を受ける面が実質的に凹凸がないように構成されていることを特徴とするものである。

【0018】

請求項7によると、外部から力を受ける面には凹凸がなく平坦であるため、測定するための特別な条件下ではなく、通常の条件下において力の分布を測定することができる。

【0019】**【発明の実施の形態】**

以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。

【0020】

まず、本発明の実施の形態に係るセンサシート1の構成について、図1を参照しつつ説明する。図1は、本発明の実施の形態に係るセンサシートの斜視図である。

【0021】

図1のセンサシート1は、例えば人の歩行時において足裏で地面を蹴り上げる様子や地面に着地する様子を測定および解析するために利用されるものである。従って、本実施の形態のセンサシート1は、人が歩行することが可能な幅および長さを有するシート状の部材である。センサシート1は、マトリックス状に配置された多数のセンサセル10を有している。ここで、本実施の形態のセンサシート1では、多数のセンサセル10は10mm間隔程度で配列されているが、多数のセンサセル10間の間隔は任意に変更することができる。なお、本実施の形態では、各センサセル10は、後述するように、静電容量式センサを含んでいる。

【0022】

ここで、1つのセンサセル10の構成について、図2および図3を参照して説

明する。図 2 は、図 1 のセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。図 3 は、図 2 のセンサセルの基板上に形成されている複数の電極の配置を示す図である。なお、センサシート 1 に含まれる多数のセンサセル 1 0 の構成は全て同じである。

【0 0 2 3】

センサセル 1 0（図 2 において一点鎖線で囲まれる範囲）は、基板 2 0 と、基板 2 0 上に形成された容量素子用電極 D 1 ～D 5（図 2 では D 1、D 2 および D 5 のみを示す）と、基準電極（共通電極）D 0 と、変位電極 3 0 と、外部から加えられる力を受けるカバー層 4 0 と、カバー層 4 0 と変位電極 3 0 との間に配置されたコア 5 0 と、支持部材 6 0 と、容量素子用電極 D 1 ～D 5 に密着して基板 2 0 上を覆うように配置された絶縁膜（レジスト膜）7 0 と、センサ回路部品 8 0 とを有している。なお、本実施の形態では、基板 2 0 およびカバー層 4 0 は、センサシート 1 に含まれる全てのセンサセル 1 0 に対して共通の部材である。

【0 0 2 4】

ここでは、1 つのセンサセル 1 0 の構成を説明するために、便宜上、図示のとおり、X Y Z 三次元座標系を定義し、この座標系を参照しながら各部品に配置説明を行うことにする。すなわち、図 2 では、センサセル 1 0 の基板 2 0 上の基準電極 D 0 の中心位置に原点 O が定義され、右水平方向に X 軸が、紙面に垂直奥行方向に Y 軸が、上垂直方向に Z 軸がそれぞれ定義されている。従って、基板 2 0 の表面は、X Y 平面を規定し、1 つのセンサセル 1 0 に対応する変位電極 3 0 およびコア 5 0 のそれぞれの中心位置を Z 軸が通ることになる。

【0 0 2 5】

基板 2 0 は、可撓性を有するフレキシブル・プリント・サーキット基板（FPC）であり、この例ではポリイミドフィルムなどのフィルム状の基板が用いられている。また、基板 2 0 として、例えばガラスエポキシ基板などの一般的な電子回路用のプリント回路基板であってもよい。なお、基板 2 0 の下面には、マイコンおよびセンサ回路（電子回路）などを含むセンサ回路部品 8 0 が設けられている。

【0 0 2 6】

基板 20 上には、図 3 に示すように、原点 O を中心とする円形の基準電極 D0 と、基準電極 D0 の外側に配置された環状の容量素子用電極 D5 と、容量素子用電極 D5 の外側に配置された略扇形である容量素子用電極 D1 ~ D4 とが設けられている。なお、容量素子用電極 D1 ~ D5 および基準電極 D0 は、銅箔で形成されてもよいし、例えばカーボンや銀などを材料とする導電性インクなどによるスクリーン印刷法により形成されてもよい。

【0027】

ここで、容量素子用電極 D1 は X 軸の正方向に対応するように配置され、容量素子用電極 D2 は X 軸の負方向に対応するように配置されており、外部からの力の X 軸方向成分の検出に利用される。また、容量素子用電極 D3 は Y 軸の正方向に対応するように配置され、容量素子用電極 D4 は Y 軸の負方向に対応するように配置されており、外部からの力の Y 軸方向成分の検出に利用される。なお、一对の容量素子用電極 D1 および容量素子用電極 D2 とは、X 軸方向に離隔して Y 軸に対して線対称に配置されており、一对の容量素子用電極 D3 および容量素子用電極 D4 は、Y 軸方向に離隔して X 軸に対して線対称に配置されている。また、容量素子用電極 D5 は原点 O に対して対称に配置されており、外部からの力の Z 軸方向成分の検出に利用される。

【0028】

変位電極 30 は、例えばシリコンゴムなどの導電性および弾性を有する材料で形成されており、基板 20 の上方において、容量素子用電極 D1 ~ D5 に対向するように配置されている。ここで、変位電極 30 は、基板 20 との間に所定間隔の空隙が形成されるように支持部材 60 により支持されている。従って、後述するように、変位電極 30 と容量素子用電極 D1 ~ D5 との間には、容量素子 C1 ~ C5 が構成されることになる。なお、後で詳述するように、変位電極 30 と容量素子用電極 D1 ~ D5 との間の間隔は、カバー層 40 に外部から力が加えられた場合には狭くなって、その加えられた力が解除されると元の間隔に戻ることが可能であるため、容量素子 C1 ~ C5 はいずれも可変容量素子であると考えられる。

【0029】

また、基板 20 上には、例えばレジストインクなどの絶縁膜 70 が、容量素子用電極 D1～D5 に密着して基板 20 上を覆うように配置されている。従って、変位電極 30 が容量素子用電極 D1～D5 に近づく方向に変位した場合でも、変位電極 30 と容量素子用電極 D1～D5 とが直接接触することがないので、センサ回路の誤作動が生じることがない。なお、基板 20 上の基準電極 D0 は絶縁膜 70 により覆われてないで露出しているので、基準電極 D0 の表面に対しては、例えばハンダ、金、銀などのメッキを形成することによって、酸化防止対策を施しておくことが好ましい。

【0030】

ここで、変位電極 30 の下面（基板 20 に対向する面）の中心位置には、基準電極 D0 とほぼ同じ或いは若干小さい径を有する円柱形状の突起部 30a が形成されている。なお、カバー層 40 に外部から力が加えられていない場合には、突起部 30a の先端部と基板 20 上の基準電極 D0 とは接触しないで、両者は離隔している。つまり、変位電極 30 の突起部 30a の高さは、変位電極 30 と基板 20 との間に形成される空隙の間隔よりも小さくなっている。

【0031】

また、変位電極 30 の上面（基板 20 に対向しない面）の中心位置には、容量素子用電極 D1～D4 のそれぞれの外側の曲線を結んでできる円の径よりも若干小さい外径を有する円形の凹部 30b が形成されている。なお、凹部 30b の深さは、コア 50 の厚さのほぼ半分と一致している。

【0032】

なお、変位電極 30 としては、例えばシリコンゴム以外の導電性ゴム、導電性熱可塑性樹脂（PPT、エラストマー）、導電性プラスチック、金属などで形成されたものであってもよい。

【0033】

支持部材 60 は、センサシート 1 に含まれる多数のセンサセル 10 を互いに仕切るように設けられており、各センサセル 10 のそれぞれの変位電極 30 を基板 20 に対して支持するためのものである。また、支持部材 60 は、例えばシリコンゴムなどの弾性を有する材料で形成されている。

【 0 0 3 4 】

コア 5 0 は、金属製の円柱形状の部材であって、カバー層 4 0 に外部から加えられた力を変位電極 3 0 に対して効率よく伝達するためのものである。ここで、コア 5 0 は、変位電極 3 0 に形成された凹部 3 0 b とほぼ同じ径を有しており（ほぼ同じ円形断面を持っており）、凹部 3 0 b の深さのほぼ 2 倍の厚さを有している。従って、コア 5 0 が、変位電極 3 0 の凹部 3 0 b 内に挿入されると、その上端側のほぼ半分の部分が変位電極 3 0 の上面から突出するようになる。

【 0 0 3 5 】

なお、コア 5 0 は、必ずしも金属製の円柱形状の部材である必要はなく、変位電極 3 0 およびカバー層 4 0 が形成される材料よりも硬質の材料であれば、例えば樹脂などのその他の材料で形成されていてもよいし、例えば四角柱形状などのその他の形状のものであってもよい。

【 0 0 3 6 】

カバー層 4 0 は、外部から加えられる力を直接受けるための膜状の部材であって、変位電極 3 0 およびコア 5 0 の上面を覆うように配置されている。ここで、カバー層 4 0 は、弾性を有するシリコンゴムで形成されている。そして、カバー層 4 0 の下面には、コア 5 0 とほぼ同じ径を有し、コア 5 0 の厚さのほぼ半分の深さの凹部 4 0 a が形成されている。従って、カバー層 4 0 は、変位電極 3 0 およびコア 5 0 の上面のほとんど全てを密着して覆うことができる。また、カバー層 4 0 の上面（露出面）は、凹凸がなく平坦になるように形成されている。なお、カバー層 4 0 は、例えばシリコンゴム以外のゴム、塩化ビニルなどの合成樹脂などの弾性を有する材料で形成されていてもよい。

【 0 0 3 7 】

なお、本実施の形態では、変位電極 3 0 およびカバー層 4 0 は、いずれも弾性を有する（柔軟性に富んだ）シリコンゴムで形成されているため、センサセル 1 0（カバー層 4 0）に加わる力の衝撃を緩和することができて、センサセル 1 0 を保護し耐久性を向上させる効果があると共に、さらに防塵および防水の効果がある。また、変位電極 3 0 およびカバー層 4 0 は、コア 5 0 が変位した場合には、それに十分対応して弾性変形することができる。

【0038】

また、カバー層 40 と変位電極 30 とは、必ずしもコア 50 の厚さ方向のほぼ中心位置で接続される必要はなく、コア 50 と接触しない位置で接続されてもよい。従って、例えば、カバー層 40 を用いなくて変位電極 40 によりコア 50 が囲まれるように構成してもよいし、変位電極 40 の上方においてカバー層 40 によりコア 50 が囲まれるように構成してもよい。

【0039】

次に、センサセル 10 の回路構成について、図 4 を参照して説明する。図 4 は、図 2 に示すセンサセルの構成に対する等価回路図である。

【0040】

センサセル 10 では、基板 20 上に設けられた容量素子用電極 D1～D5 と変位電極 30 とは対向しており、共通の電極である変位可能な変位電極 30 と、固定された個別の容量素子用電極 D1～D5 との間で容量素子 C0～C5 が構成されている。ここで、容量素子 C1～C5 は、上述したように、それぞれ変位電極 30 の変位に起因して静電容量値が変化するように構成された可変容量素子である。

【0041】

そして、容量素子用電極 D1～D5、基準電極 D0 は、それぞれ端子 T1、T2、T0 のいずれかを通じて、基板 20 の下面に設けられたセンサ回路部品 80 のセンサ回路などに接続されている。なお、本実施の形態では、基準電極 D0 は、端子 T0 を介して接地されている。

【0042】

また、変位電極 30（詳しくは、その突起部 30a）と基準電極 D0 との間には、スイッチ S1 が形成されている。つまり、変位電極 30 が、基準電極 D0 と接触する状態（オン状態）および基準電極 D0 と接触しない状態（オフ状態）のいずれかの状態を取り得るようになっている。

【0043】

ここで、本実施の形態のセンサセル 10 においては、カバー層 40 に対して外部から力が加えられていない場合には、変位電極 30 と基準電極 D0 とは離隔し

ており（スイッチ S 1 がオフ状態であり）、変位電極 30 は特定の電圧に維持されておらず絶縁された状態（浮いた状態）となっている。従って、このとき、変位電極 30 と容量素子用電極 D 1 ～ D 5 との間には電圧がかからないため、容量素子 C 1 ～ C 5 に蓄えられている電荷量は無視できる程度に小さい。なお、容量素子用電極 D 1 ～ D 5 の周囲には、浮遊容量が存在する場合があるが、容量素子 C 1 ～ C 5 と比較して十分に小さいので無視することにする。

【0044】

一方、カバー層 40 に対して外部から所定以上の力が加えられる場合には、変位電極 30 と基準電極 D 0 とは接触し（スイッチ S 1 がオン状態になり）、変位電極 30 が基準電極 D 0 を介して接地されるため、容量素子用電極 D 1 ～ D 5 に電圧を印可すると、容量素子 C 1 ～ C 5 に電荷が蓄積されるようになり、容量素子 C 1 ～ C 5 に蓄えられる電荷量は、スイッチ S 1 がオフ状態の場合と比較すると、急激に大きくなる。なお、変位電極 30 が基準電極 D 0 に接触する状態においては、容量素子用電極 D 1 ～ D 5 のそれぞれに接続された端子 T 1 または端子 T 2 から入力され、そして容量素子 C 1 ～ C 5 を含む遅延回路を通過した周期信号を利用して、外部から加えられた力を検出することができる。

【0045】

このように、スイッチ S 1 がオフ状態では、容量素子 C 1 ～ C 5 に蓄えられている電荷量は無視できる程度に小さく、センサセル 10 の容量素子 C 1 ～ C 5 に対応した出力信号は一定の大きさに安定している。一方、スイッチ S 1 がオン状態では、容量素子 C 1 ～ C 5 に蓄えられている電荷量は急激に大きくなり、センサセル 10 の容量素子 C 1 ～ C 5 に対応した出力信号は、容量素子 C 1 ～ C 5 の静電容量値の変化量に応じて大きく変化する。

【0046】

従って、カバー層 40 に対して外部から力が加えられる前およびその後における容量素子 C 1 ～ C 5 に蓄えられている電荷量は、カバー層 40 に対して外部から力が加えられている間の電荷量と比較すると、いずれも無視できる程度に小さい。そのため、カバー層 40 の位置が元の位置からずれることによって、変位電極 30 の位置再現性が悪い場合でも、外部から力が加えられる前およびその後に

おけるセンサセル 10 の容量素子 C 1 ~ C 5 に対応する出力信号は、それぞれほとんど同じになり、再現性よく元の値に戻るようになる。従って、センサセル 10 においては、容量素子 C 1 ~ C 5 に対応する出力信号のヒステリシスを低減することができる。

【0047】

次に、上述のように構成されたセンサセル 10 の動作について、図 5 を参照して説明する。図 5 は、図 2 に示すセンサセルに対して外部から力が加えられた場合の側面の模式的な断面図である。なお、図 5 では、X 軸方向成分 F_x および Z 軸方向成分 F_z から構成された力 F が加えられた場合について図示されている。

【0048】

カバー層 40 に対して外部から力 F が加えられると、カバー層 40 がたわむことにより、カバー層 40 の力 F が加えられた部分近傍が下方に押し下げられる。このとき、カバー層 40 の当該部分近傍に対応するコア 50 および変位電極 30 のそれぞれの部分が下方に変位する。そして、変位電極 30 の中央部が所定の高さだけ押し下げられると、変位電極 30 の突起部 30 a が基準電極 D 0 と接触するようになる。これにより、スイッチ S 1 がオフ状態からオン状態に切り換わる。

【0049】

その後、引き続き、カバー層 40 の当該部分近傍が押し下げられると、スイッチ S 1 がオン状態を保持しつつ、カバー層 40、変位電極 30 および支持部材 60 が弾性変形を生じてたわみ、変位電極 30 の力 F に対応する部分、つまり、図 5 では変位電極 30 の X 軸正方向部分はさらに下方へと変位する。なお、変位電極 30 の X 軸正方向部分と X 軸負方向部分とは、突起部 30 a を支点として互いに上下反対方向に変位するようになっている。従って、変位電極 30 の X 軸正方向部分が下方へと変位したときには、変位電極 30 の X 軸負方向部分は突起部 30 a を支点として上方へと変位する。

【0050】

また、変位電極 30 の Y 軸正方向部分の X 軸正方向側は下方に若干変位し、X 軸負方向側は上方に若干変位する。同様に、変位電極 30 の Y 軸負方向部分の X

軸正方向側は下方に若干変位し、X軸負方向側は上方に若干変位する。また、このとき、突起部30aが押しつぶされて弾性変形することによって、変位電極30（容量素子用電極D5に対向する部分）は全体的に下方へ変位する。

【0051】

従って、変位電極30と容量素子用電極D1と間の間隔が小さくなり、一方、変位電極30と容量素子用電極D2と間の間隔が大きくなる。また、変位電極30と容量素子用電極D5との間隔が小さくなる。また、このとき、変位電極30のY軸正方向部分と容量素子用電極D3との間隔、および、変位電極30のY軸負方向部分と容量素子用電極D4との間隔は平均すると変化しないと考えられる。なお、実際には、上述のように、変位電極30のY軸正方向部分およびY軸負方向部分のそれぞれX軸正方向側は下方に若干変位し、X軸負方向側は上方に若干変位するが、変位電極30のY軸正方向部分およびY軸負方向部分の全体としての容量素子用電極D3、D4との間隔は変化しないと考えられる。

【0052】

このように、カバー層40に対して外部から力Fが加えられた場合には、容量素子C1～C5のなかで、変位電極30と容量素子用電極D1～D5との間の間隔に変化があった容量素子C1、C2、C5の静電容量値のみが変化する。このとき、X軸方向成分を検出するための信号処理回路においては、端子T1およびT2に輸入された周期信号Aおよび周期信号Bには、容量素子C1、C2を含む遅延回路を通過することによって、それらの位相にずれが生じる。そして、それらの位相のずれが読み取られることによって、力FのX軸方向成分 F_x に対応する出力信号 V_x が導出される。これと同様に、Z軸方向成分を検出するための信号処理回路においては、端子T1に輸入された周期信号Aには、容量素子C5を含む遅延回路を通過することによって、その位相にずれが生じる。そして、その位相のずれ（実際には、端子T2に輸入された周期信号Bの位相とともに）が読み取られることによって、力FのZ軸方向成分 F_z に対応する出力信号 V_z が導出される。

【0053】

次に、容量素子C1～C5のそれぞれの静電容量値の変化から、外部から加え

られた力の大きさおよび方向を示す出力信号の導出方法について、図 6 を参照して説明する。図 6 は、図 2 に示すセンサセルに入力される周期信号から出力信号を導出する方法を説明するための説明図である。ここで、出力信号 V_x 、 V_y 、 V_z は、それぞれ外部から加えられる力の X 軸方向成分、Y 軸方向成分および Z 軸方向成分に対応するものである。

【0 0 5 4】

なお、図 6 に示す容量素子 C 6 は、常に一定の静電容量値を保つように基板 2 0 の下面に形成されており、容量素子 C 6 を構成する一方の電極は出力信号 V_z を導出する C/V 変換回路に接続されており、他方の電極は接地されている。この容量素子 C 6 は、容量素子 C 5 とともに、外部からの力の Z 軸方向成分の出力信号 V_z を導出するために用いられる。

【0 0 5 5】

ここで、出力信号 V_x 、 V_y 、 V_z を導出するために、端子 T 1、T 2 に対して、クロック信号などの周期信号が入力される。そして、端子 T 1、T 2 に周期信号が入力されている状態で、カバー層 4 0 が外部からの所定の大きさ以上の力を受けて押し下げられると、これに伴って変位電極 3 0 の中心位置近傍が Z 軸負方向に変位し、突起部 3 0 a と基準電極 D 0 との間に構成されたスイッチ S 1 がオン状態となる。その後、容量素子 C 1 ~ C 5 のそれぞれの電極間隔が変化して、容量素子 C 1 ~ C 5 のそれぞれの静電容量値が変化する。このとき、端子 T 1、T 2 に入力された周期信号に生じる位相のずれを利用して、変位電極 3 0 の変位、つまり、カバー層 4 0 が外部から受けた力の X 軸方向成分、Y 軸方向成分および Z 軸方向成分に対応する出力信号 V_x 、 V_y 、 V_z を得ることができる。

【0 0 5 6】

さらに詳細に説明すると、端子 T 1 に対して周期信号 A が入力されるとき、端子 T 2 に対しては周期信号 A と同一の周期で、かつ、周期信号 A の位相とは異なる周期信号 B が入力される。そのとき、カバー層 4 0 が外部から力を受けて、容量素子 C 1 ~ C 5 の静電容量値がそれぞれ変化すると、端子 T 1、T 2 にそれぞれ入力された周期信号 A および周期信号 B の少なくともいずれかの位相にずれが生じる。つまり、各方向成分を検出するための信号処理回路においては、容量素

子C 1、C 3、C 5の静電容量値が変化すると、端子T 1にそれぞれ入力された周期信号Aの位相にずれが生じ、一方、容量素子C 2、C 4の静電容量値が変化すると、端子T 2にそれぞれ入力された周期信号Bの位相にずれが生じる。

【0057】

すなわち、外部からの力にX軸方向成分が含まれる場合は、X軸方向成分を検出するための信号処理回路においては、容量素子C 1の静電容量値が変化して端子T 1に入力された周期信号Aの位相にずれが生じるか、或いは、容量素子C 2の静電容量値が変化して端子T 2に入力された周期信号Bの位相にずれが生じるかのいずれか或いは両方である。ここで、容量素子C 1、C 2の静電容量値の変化は、外部からの力のX軸正方向成分、X軸負方向成分にそれぞれ対応している。このように、端子T 1および端子T 2にそれぞれ入力された周期信号Aおよび周期信号Bの位相のずれを例えば排他和回路などで読み取ることによって、出力信号 V_x が導出される。この出力信号 V_x の変化量の符号が、外部からの力のX軸方向成分が正方向または負方向の向きかを示し、出力信号 V_x の変化量の絶対値がX軸方向成分の大きさを示す。なお、本実施の形態では、端子T 1に入力された周期信号Aの位相のずれと、端子T 2に入力された周期信号Bの位相のずれとは、互いに逆方向の位相のずれになることが多い。

【0058】

また、外部からの力にY軸方向成分が含まれる場合は、Y軸方向成分を検出するための信号処理回路においては、容量素子C 3の静電容量値が変化して端子T 1に入力された周期信号Aの位相にずれが生じるか、或いは、容量素子C 4の静電容量値が変化して端子T 2に入力された周期信号Bの位相にずれが生じるかのいずれか或いは両方である。ここで、容量素子C 3、C 4の静電容量値の変化は、外部からの力のY軸正方向成分、Y軸負方向成分にそれぞれ対応している。このように、端子T 1および端子T 2にそれぞれ入力された周期信号Aおよび周期信号Bの位相のずれを例えば排他和回路などで読み取ることによって、出力信号 V_y が導出される。この出力信号 V_y の変化量の符号が、外部からの力のY軸方向成分が正方向または負方向の向きかを示し、出力信号 V_y の変化量の絶対値がY軸方向成分の大きさを示す。なお、本実施の形態では、端子T 1に入力された

周期信号 A の位相のずれと、端子 T 2 に入力された周期信号 B の位相のずれとは、互いに逆方向の位相のずれになることが多い。

【0 0 5 9】

さらに、外部からの力に Z 軸方向成分が含まれる場合は、Z 軸方向成分を検出するための信号処理回路においては、容量素子 C 5 の静電容量値が変化して端子 T 1 に入力された周期信号 A の位相にずれが生じる。また、容量素子 C 6 の静電容量値は一定に保たれているため、端子 T 2 に入力された周期信号 B の位相にはずれが生じない。従って、端子 T 1 に入力された周期信号 A にのみ位相のずれが生じ、この周期信号 A の位相のずれを排他和回路で読み取ることによって、出力信号 V_z が導出される。この出力信号 V_z の変化量の符号が、外部からの力の Z 軸方向成分が正方向または負方向の向きかを示し、出力信号 V_z の変化量の絶対値が Z 軸方向成分の大きさを示す。

【0 0 6 0】

なお、外部からの力に X 軸方向成分または Y 軸方向成分が含まれる場合において、カバー層 4 0 に対する力の加わり方によっては、次のような場合が考えられる。例えば、X 軸方向について考えると、変位電極 3 0 の X 軸正方向部分と X 軸負方向部分とが、突起部 4 0 a を支点として互いに上下反対方向に変位することなく、X 軸正方向部分および X 軸負方向部分がともに下方へと変位し、かつ、そのときのそれぞれの変位量が異なる場合がある。この場合には、端子 T 1 および T 2 に入力されたそれぞれの周期信号 A および周期信号 B の位相には、同じ方向のずれが生じることとなるが、上述した場合と同様に、その位相のずれを排他和回路で読み取ることによって、出力信号 V_x が導出される。また、このことは、Y 軸方向についての出力信号 V_y の導出に対しても同様のことがいえる。

【0 0 6 1】

次に、端子 T 1、T 2 に入力された周期信号 A、B による出力信号 V_x 、 V_y 、 V_z を導出するための信号処理回路について、図 7 を参照しながら説明する。図 7 は、図 2 に示すセンサセルの信号処理回路を示す回路図である。

【0 0 6 2】

図 7 に示すように、端子 T 1、T 2 には、図示されていない交流信号発振器か

ら所定周波数の周期信号が入力される。そして、端子T1には、抵抗素子R1、R3、R5がそれぞれ接続されており、端子T2には、抵抗素子R2、R4、R6がそれぞれ接続されている。また、抵抗素子R1、R2の出力端、抵抗素子R3、R4の出力端および抵抗素子R5、R6の出力端には、それぞれ排他和回路の論理素子であるEX-OR素子91~93が接続されており、その出力端は端子T11~T13に接続されている。また、抵抗素子R1~R5の出力端は、変位電極30との間で容量素子C1~C5を構成している容量素子用電極D1~D5にそれぞれ接続されている。なお、図7では、変位電極30と基準電極D0とが接触している状態が図示されており、容量素子C1~C5を構成する一方の電極である変位電極30は接地されている。

【0063】

ここから、例として、X軸方向成分の出力信号 V_x の導出方法について、図8および図9を参照して説明する。図8は、図2に示すセンサセルのX軸方向成分についての信号処理回路を示す回路図（図7の一部）である。図9は、図8に示す信号処理回路の各端子および各節点における周期信号の波形を示す図である。

【0064】

図8の信号処理回路において、容量素子C1および抵抗素子R1、並びに、容量素子C2および抵抗素子R2は、それぞれCR遅延回路を形成している。従って、端子T1、T2のそれぞれに入力された周期信号（矩形波信号）は、CR遅延回路を通過することにより、それぞれ所定の遅延を生じて、それぞれEX-OR素子91に入力される。

【0065】

詳細に説明すると、端子T1には周期信号 $f(\phi)$ （上述の周期信号Aに対応している）が入力され、また、端子T2には $f(\phi)$ と同一の周期で、かつ、位相が θ だけずれている周期信号 $f(\phi + \theta)$ （上述の周期信号Bに対応している）が入力される。端子T1に入力される周期信号 $f(\phi)$ は、容量素子C1と抵抗素子R1により構成されるCR遅延回路を通過して、節点X1に到達する。このとき、節点X1における周期信号には、図9に示すように、時間aの遅延が生

じている。同様に、端子 T 2 に入力される周期信号 $f(\phi + \theta)$ は、容量素子 C 2 と抵抗素子 R 2 により構成される C R 遅延回路を通過して、節点 X 2 に到達する。このとき、節点 X 2 における周期信号には、時間 b の遅延が生じている。

【0066】

ここで、時間 a、b は、それぞれ C R 遅延回路における遅延時間に対応し、それぞれの C R の時定数により決定される。したがって、抵抗素子 R 1、R 2 の抵抗値が同一である場合は、時間 a、b の値は容量素子 C 1、C 2 の静電容量値に対応するようになる。すなわち、容量素子 C 1、C 2 の静電容量値が大きくなると、時間 a、b の値も大きくなり、容量素子 C 1、C 2 の静電容量値が小さくなると、時間 a、b の値も小さくなる。

【0067】

このように、E X-O R 素子 9 1 には、節点 X 1、X 2 における周期信号と同一の波形の信号が入力され、これらの信号の間で排他的論理演算が行われ、その結果を端子 T 1 1 に対して出力される。ここで、端子 T 1 1 に対して出力される信号は、所定のデューティ比をもった矩形波信号である（図 9 参照）。

【0068】

ここで、上述したように、カバー層 4 0 に対して外部から力が加えられた場合（図 5 参照）の各端子および各節点における周期信号の波形を考えることにする。なお、この場合の信号処理回路における容量素子用電極 D 1、D 2 と変位電極 3 0 との間で構成される容量素子を C 1'、C 2' とし、カバー層 4 0 に対して外部から力が加えられていない場合の信号処理回路の節点 X 1、X 2 および端子 T 1 1 と同位置における各節点および端子を節点 X 1'、X 2' および端子 T 1 1' とする（図 8 参照）。

【0069】

このとき、図 8 の信号処理回路において、上述と同様に、端子 T 1 には周期信号 $f(\phi)$ が入力され、端子 T 2 には、 $f(\phi)$ と同一の周期で位相が θ だけずれている周期信号 $f(\phi + \theta)$ が入力される。端子 T 1 に入力される周期信号 $f(\phi)$ は、容量素子 C 1' と抵抗素子 R 1 により構成される C R 遅延回路を通過して、節点 X 1' に到達する。このとき、節点 X 1' における周期信号には、図

9に示すように、時間 $a + \Delta a$ の遅延が生じている。これは、容量素子 $C1'$ の静電容量値が容量素子 $C1$ よりも大きくなったことにより、 CR 遅延回路の時定数が大きくなったためである。また同様に、端子 $T2$ に入力される周期信号 f ($\phi + \theta$) は、容量素子 $C2'$ と抵抗素子 $R2$ により構成される CR 遅延回路を通過して、節点 $X2'$ に到達する。このとき、節点 $X2'$ における周期信号には、時間 $b - \Delta b$ の遅延が生じている。これは、容量素子 $C2'$ の静電容量値が容量素子 $C2$ よりも小さくなったことにより、 CR 遅延回路の時定数が小さくなったためである。

【0070】

このように、 $EX-OR$ 素子 91 には、節点 $X1'$ 、 $X2'$ における周期信号と同一の波形の信号が入力され、これらの信号の間で排他的論理演算が行われ、その結果を端子 $T11'$ に対して出力される。ここで、端子 $T11'$ に対して出力される信号は、所定のデューティ比をもった矩形波信号であり、図 9 に示すように、カバー層 40 に対して外部から力が加えられていない場合において、端子 $T11$ に出力された矩形波信号よりも、デューティ比の小さい矩形波信号である。

【0071】

ここで、センサセル 10 では、上述したように、変位電極 30 には突起部 30a が形成されており、変位電極 30 が突起部 30a を支点として変位するため、容量素子 $C1'$ 、 $C2'$ の静電容量値は、一方が大きくなると他方が小さくなるというように、大小反対に変化することが多い。これにより、それぞれの容量素子 $C1'$ 、 $C2'$ が構成する CR 遅延回路の時定数も同様に変化し、出力される矩形波信号のデューティ比の変化が著しくなるため、カバー層 40 に加えられた力の検出を容易に行うことができる。なお、力がセンサセル 10 全体に作用する場合は、容量素子 $C1'$ 、 $C2'$ の静電容量値は両方とも大きくなるが、作用する力のバランスに応じて容量素子 $C1'$ 、 $C2'$ の静電容量値の変化量が異なるので同様にカバー層 40 に加えられた力の検出を行うことができる。

【0072】

なお、 Z 軸方向成分の出力信号 V_z を導出するための信号処理回路（図 7 参照

) は、端子 T 5 に入力された信号にのみ C R 遅延回路を通過することにより所定の遅延を生じるが、端子 T 6 に入力された信号は C R 遅延回路を通過しないため C R 遅延回路による遅延は生じない。このように、一方の信号にのみ遅延が生じる回路においても、上述と同様にして、カバー層 40 に加えられた力の検出を行うことができる。

【0073】

このように、容量素子 C 1、C 2 のそれぞれの静電容量値の変化が、端子 T 1 における波形のデューティ比の変化として検出され、この信号を平滑回路を通過させて平滑することにより、このデューティ比をアナログ電圧値に変換して利用することができる。このアナログ電圧値は、出力信号のデューティ比に比例して変化する。従って、出力信号のデューティ比が大きくなるとそれに伴ってアナログ電圧値も大きくなり、一方、出力信号のデューティ比が小さくなるとそれに伴ってアナログ電圧値も小さくなる。また、出力信号のデューティ比がほとんど変化しないときはアナログ電圧値もほとんど変化しない。また、T 1 における信号のハイレベル (H i) またはローレベル (L o) の時間を、より周波数の高いクロック信号でカウントすれば、デューティ比をデジタルカウント値に変換して利用することもできる。

【0074】

ここで、端子 T 1、T 2 にそれぞれ入力される異なる位相の周期信号 $f(\phi)$ 、 $f(\phi + \theta)$ は、1つの周期信号発振器から出力された周期信号を2つの経路に分け、その一方の経路に図示しない C R 遅延回路を設け、C R 遅延回路を通過する周期信号の位相を遅延させることによって発生させられる。なお、周期信号の位相をずらせる方法は、C R 遅延回路を用いる方法に限らず、他のどのような方法であってもよいし、また、2つの交流信号発振器を用いて、それぞれ異なる位相の周期信号 $f(\phi)$ 、 $f(\phi + \theta)$ を発生させ、端子 T 1、T 2 のそれぞれに入力してもよい。

【0075】

以上説明したように、センサシート 1 に含まれる各センサセル 10 においては、各センサセル 10 のそれぞれに対応するカバー層 40 に対して外部から加えら

れた力について、そのX軸方向成分、Y軸方向成分およびZ軸方向成分を検出することが可能である。従って、各センサセル10において検出された力の各方向成分に基づいて、センサシート1全体では、その表面における外部から加えられた力の分布を測定することができる。

【0076】

例えば、歩行解析においては、センサシート1上を被験者が歩行した場合の時間経過と各センサセル10の出力の関係を測定すれば、被験者固有の歩行パターンを測定することができる。このとき、センサシート1に平行な剪断力も合わせて三次元的に測定および解析が可能であるため、人間工学分野の研究に貢献することができる。なお、センサシート1の表面は平坦になっているので、歩行の際に障害となるものが無く、平常とほぼ同じ条件で歩行パターンを測定することができる。

【0077】

なお、センサセル10では、上述したように、変位電極30の突起部30aと基準電極D0とが接触している場合においてのみ、外部から加えられた力を検出することが可能である。従って、カバー層40に対して基板20に平行な力（X軸方向成分および／またはY軸方向成分の力）だけが作用する場合には、変位電極30の突起部30aと基準電極D0とが接触しないため、その力を測定することができない。しかしながら、例えば、上述のようにセンサシート1上を人が歩行する場合には、Z軸方向に力を加えないで歩行することが不可能であって、歩行時には常にZ軸方向の力を加えながら歩行することになる。従って、このような測定上の制限があるとしても、実用上全く問題がないと考えられる。

【0078】

一方、カバー層40に対して基板20に平行な力だけが作用する場合に力の検出が不能になることによって、以下のような効果を得ることができる。例えば、上述の歩行解析において、センサセル10の大きさ（面積）が非常に小さい場合には、被験者の足裏が接触していないセンサセル10においても、それに近接するその他のセンサセル10のカバー層40が被験者の歩行により変位または変形することによって、そのセンサセル10の変位電極30が若干変位することがあ

る。本実施の形態のセンサシート 1 では、変位電極 30 の突起部 30 a と基準電極 D0 との間にスイッチ S1 が形成されているため、Z 軸方向について変位電極 30 の突起部 30 a と基準電極 D0 とを接触させる程度の大きさ以上の力が加えられて変位電極 30 が接地電位に接続されたセンサセル 10 だけが、力覚センサとして機能するので力の分布を測定する際の精度を向上させることができる。

【0079】

なお、本実施の形態のセンサセル 10 の構成とは異なり、変位電極が常に接地電位に維持されている場合には、上述のような効果は得られず、被験者の足裏が接触していないセンサセルにおいても、それに近接するその他のセンサセルに加えられた力によって、その変位電極が変位することによりセンサセルの出力が変化して測定誤差の原因となって、力の分布を測定する際の精度が著しく低下する。

【0080】

なお、本実施の形態のセンサシート 1 は、上述の歩行解析の他、例えば、自動車用シートに人が着座した際に運転状況により人が慣性力で揺すられる状態を自動車用シートに作用する体圧分布として三次元的にダイナミックに解析を行う場合に有効である。また、これら以外にも、センサシート 1 に平行な剪断力が働く場合の圧力分布を測定する手段として利用するときにも、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0081】

また、センサシート 1 の耐荷重は、例えば、センサセル 10 の大きさ、変位電極 30 およびカバー層 40 を形成する材料の硬度または厚さなどを変更することによって、適宜調整することができる。

【0082】

以上のように、本実施の形態に係るセンサシート 1 においては、各センサセル 10 が外部から加えられた力の X 軸方向成分、Y 軸方向成分および Z 軸方向成分をそれぞれ検出することができる。従って、センサシート 1 全体において、外部から加えられた力のカバー層 40 に垂直方向成分およびそれに平行な 2 方向成分を含む 3 次元の力の分布を測定することができる。従って、センサシート 1 に作

用する力の詳細な解析を行うことが可能となる。

【0083】

また、センサセル 10 に対して外部から力が加えられていない場合には、変位電極 30 が絶縁状態に維持されているため、容量素子用電極 D1～D5 と変位電極 30 との間に構成される容量素子 C1～C5 には電圧がかからない。そのため、容量素子 C1～C5 に蓄えられている電荷量が無視できる程度に小さくなり、センサセル 10 からの出力信号は一定の大きさに安定している。一方、センサセル 10 に対して外部から力が加えられると、変位電極 30 が接地された基準電極 D0 と接触するため、容量素子 C1～C5 に電圧がかかるようになる。そのため、容量素子 C1～C5 に蓄えられている電荷量が急激に大きくなり、センサセル 10 からの出力信号が容量素子 C1～C5 の静電容量値の変化に応じて大きく変化する。このように、外部から力が加えられる前およびその後における容量素子 C1～C5 に蓄えられている電荷量は、外部から力が加えられている間の電荷量と比較すると、いずれも無視できる程度に小さい。そのため、変位電極 30 の復帰位置が元の位置からずれた場合でも、外部から力が加えられる前およびその後におけるセンサセル 10 の各容量素子 C1～C5 に対応する（各容量素子用電極 D1～D5 からの）出力信号はほとんど同じになる。これにより、センサセル 10 の各容量素子 C1～C5 に対応する出力信号のヒステリシスを低減することができる。

【0084】

また、変位電極 30 と基準電極 D0 とが互いに接触する状態および接触しない状態のいずれかの状態を取りうるスイッチ S1 として機能するため、外部から力が加えられていないセンサセル 10 の変位電極 30 が、当該センサセル 10 に近接するその他のセンサセルに対して外部から加えられた力によって当該センサセル 10 の変位電極 30 と基準電極 D0 とが接触しない程度に変位した場合でも、当該センサセル 10 の出力が変化することがない。従って、当該センサセル 10 に近接するその他のセンサに加えられる力によって、当該センサセル 10 に測定誤差が生じて、力の分布の測定精度が著しく低下するのを抑制することができる。

【0085】

また、カバー層40と変位電極30の間には、金属製のコア50が配置されているため、外部から加えられた力を変位電極30に効率よく伝達することができる。特に、外部から力が加えられたときの変位電極30の傾きを利用して当該力が検出される場合、つまり、変位電極30のX軸正方向部分とX軸負方向部分との変位に基づく容量素子C1、C2の各静電容量値の変化量の差を利用して当該力のX軸方向成分が検出される場合、および、変位電極30のY軸正方向部分とY軸負方向部分との変位に基づく容量素子C3、C4の各静電容量値の変化量の差を利用して当該力のY軸方向成分が検出される場合に、変位電極30の傾きが検出し易くなって、センサセル10における検出精度を向上させることができる。

【0086】

また、センサシート1は、マトリックス状に配置された多数のセンサセル10を有しており、センサセル10がセンサシート1全体に均一に配置されているため、センサシート1上に対して外部から加えられた力の分布を精度よく検出することができる。

【0087】

また、外部から力を受けるカバー層40の表面には凹凸がなく平坦であるため、測定するための特別な条件下ではなく、通常の下において力の分布を測定することができる。

【0088】

次に、本発明の実施の形態の第1の変形例について、図10を参照しつつ説明する。図10は、本実施の形態の第1の変形例のセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。

【0089】

本変形例に係るセンサシートに含まれるセンサセル110の構成が、図2のセンサセル10の構成と大きく異なる点は、センサセル10では、コア50がカバー層40と変位電極30との間に配置されているのに対して、センサセル110では、コア150がカバー層140の表面から突出している点である。なお、そ

の他の構成のうち、センサセル 10 と同様である部分については、同一で符号を付して詳細な説明は省略する。

【0090】

センサセル 110 においては、変位電極 130 は、基板 20 上に設けられた容量素子用電極 D1～D5 および基準電極 D0 に対向するように配置されており、その下面に突起部 130a が形成されており、その上面は平らになっている。そして、変位電極 130 の上面には、カバー層 140 が覆うように配置されている。カバー層 140 の表面には、コア 150 の高さのほぼ半分の深さの凹部 140a が形成されている。従って、コア 150 が、カバー層 140 の凹部 140a 内に挿入されると、その上端側のほぼ半分の部分がカバー層 140 の表面から突出するようになる。ここで、コア 150 は、外部から加えられる力を直接受ける検知部として機能することになる。また、この場合には、センサシートの表面は凹凸を有するようになる。

【0091】

なお、センサセル 110 の回路構成および動作については、第 1 の実施の形態と同様である。

【0092】

以上のように、本変形例のセンサシートにおいても、各センサセル 110 が外部から加えられた力の X 軸方向成分、Y 軸方向成分および Z 軸方向成分をそれぞれ検出することができるため、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。また、コア 150 がカバー層 140 から突出しているので、基板 20 に平行な力（X 軸方向成分および／または Y 軸方向成分の力）だけがコア 150 に作用する場合でも、変位電極 130 の突起部 130a と基準電極 D0 とを接触させることが可能となって、その力を測定することができる。

【0093】

次に、本発明の実施の形態の第 2 の変形例について、図 11 を参照しつつ説明する。図 11 は、本実施の形態の第 2 の変形例のセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。図 12 は、図 11 のセンサセルの基板上に形成されている複数の電極の配置を示す図である。

【0094】

本変形例に係るセンサシートに含まれるセンサセル210の構成が、図2のセンサセル10の構成と大きく異なる点は、センサセル10では、コア50がカバー層40と変位電極30との間に配置されており、外部から力が加えられていない場合には変位電極30が絶縁状態に維持されているのに対して、センサセル210では、コア250がカバー層240の表面から突出しており、変位電極230が常に接地されている点である。なお、その他の構成のうち、センサセル10と同様である部分については、同一で符号を付して詳細な説明は省略する。

【0095】

センサセル210においては、基板20上には、図12に示すように、原点Oを中心とする円形の容量素子用電極D205と、容量素子用電極D205の外側に配置された略扇形である容量素子用電極D201～D204と、容量素子用電極D201～D204の外側に配置された環状の基準電極D200とが設けられている。

【0096】

ここで、変位電極230の下面には、基準電極D200と同じ形状の突起部230aが形成されている。そして、変位電極230は、突起部230aの下端部と基準電極D200とが接触すると共に、基板20上に設けられた容量素子用電極D201～D205に対向するように配置されている。従って、変位電極230は、基準電極D200を介して接地されており、常に接地電位に維持されることになる。なお、本変形例では、基板20およびカバー層240と同様に変位電極230は、センサシートに含まれる全てのセンサセル210に対して共通の部材である。

【0097】

そして、変位電極230の上面には、カバー層240が覆うように配置されている。カバー層240の表面には、コア250の高さのほぼ半分の深さの凹部240aが形成されている。従って、コア250が、カバー層240の凹部240a内に挿入されると、その上端側のほぼ半分の部分がカバー層240の表面から突出するようになる。ここで、コア250は、外部から加えられる力を直接受け

る検知部として機能することになる。また、この場合には、センサシートの表面は凹凸を有するようになる。

【0098】

なお、センサセル 210 の回路構成および動作については、第 1 の実施の形態において、スイッチ S1 が常にオン状態である場合と同様であると考えられる。

【0099】

以上のように、本変形例のセンサシートにおいても、各センサセル 210 が外部から加えられた力の X 軸方向成分、Y 軸方向成分および Z 軸方向成分をそれぞれ検出することができるため、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0100】

次に、本発明の第 2 の実施の形態に係るセンサシートの構成について、図面を参照しつつ説明する。図 13 は、本発明の第 2 の実施の形態に係るセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。図 14 は、図 13 のセンサセルに含まれる複数の電極の配置を示す図である。図 15 は、図 13 に示すセンサセルの回路の概略構成図である。図 16 は、図 13 に示すセンサセルの回路図の一例である。

【0101】

第 2 の実施の形態のセンサシートの構成が、第 1 の実施の形態のセンサシート 1 の構成と大きく異なる点は、センサシート 1 では、各センサセル 10 がそれぞれ静電容量式センサを含んでいるのに対して、本実施の形態のセンサシートでは、各センサセル 310 がそれぞれ抵抗型センサを含んでいる点である。その他の構成のうち、センサセル 10 と同様である部分については、同一で符号を付して詳細な説明は省略する。なお、本実施の形態のセンサシートにおいても、多数のセンサセル 310 は、マトリックス状に配置されている。

【0102】

本実施の形態のセンサセル 310 では、基板 20 と、支持部材 60 によって基板 20 との間に所定の空隙が形成されるように支持された支持体 330 との間に、センサユニット 300 が配置されている。また、カバー層 40 と支持体 330

との間には、コア 50 が配置されている。ここで、支持体 330 は、例えばシリコンゴムなどの弾性を有する材料で形成されている。なお、コア 50 は、第 1 の実施の形態と同様に、支持体 330 の上面に形成された凹部 330 a およびカバー層 40 に形成された凹部 40 a によって囲まれている。

【0103】

センサユニット 300 は、重ね合わされた 2 枚の膜状部材 370、371 を有している。ここで、膜状部材 370、371 は、いずれも例えば PET フィルムなどで構成されている。また、膜状部材 370 と膜状部材 371 との間には、導電ランド D11～D15、D21～D25 および感圧抵抗インク R11～R15、R21～R25 が設けられている。そして、センサユニット 300 の下面（膜状部材 370 の下面）が基板 20 の表面に接触し、その上面（膜状部材 371 の上面）が支持体 330 の下面に接触するように配置されている。

【0104】

膜状部材 370 の上面（その膜状部材 371 との接合面）には、図 14（a）に示すように、原点 O'（膜状部材 370 の上面と Z 軸との交点）を中心とする円形の導電ランド D15 と、導電ランド D15 の外側に配置された略扇形である導電ランド D11～D14 とが、銀やカーボンなどを原料とする導電性インクによるスクリーン印刷によって形成されている。また、導電ランド D11～D15 上には、感圧抵抗インク R11～R15 が、それらの上にそれぞれ重なるようにスクリーン印刷されている。

【0105】

同様に、膜状部材 371 の下面（その膜状部材 370 との接合面）には、図 14（b）に示すように、原点 O''（膜状部材 371 の下面と Z 軸との交点）を中心とする円形の導電ランド D25 と、導電ランド D25 の外側に配置された略扇形である導電ランド D21～D24 とが、銀やカーボンなどを原料とする導電性インクによるスクリーン印刷によって形成されている。また、導電ランド D21～D25 上には、感圧抵抗インク R21～R25 が、それらの上にそれぞれ重なるようにスクリーン印刷されている。

【0106】

ここで、感圧抵抗インク R11～R15、R21～R25 は、圧力または接触面積によって抵抗値が変化する部材である。感圧抵抗インク R11～R14、R21～R25 としては、例えば、二酸化チタン充填剤、ビニル樹脂結合剤およびブチルセロソルブアセテート溶剤を含有する絶縁インクに、グラファイト、ビニル樹脂およびブチルセロソルブアセテートを含有する導電インクを混入したものなどが用いられる。また、感圧抵抗インクの抵抗値は、主な構成成分である絶縁成分と導電成分との相対的な割合を変えることによって容易に変化させることが可能である。

【0107】

ここで、感圧抵抗インク R11（導電ランド D11）と感圧抵抗インク R21（導電ランド D21）とが対向しており、X 軸正方向に対応するように配置されている。また、感圧抵抗インク R12（導電ランド D12）と感圧抵抗インク R22（導電ランド D22）とが対向しており、X 軸負方向に対応するように配置されている。同様に、感圧抵抗インク R13（導電ランド D13）と感圧抵抗インク R23（導電ランド D23）とが対向しており、Y 軸正方向に対応するように配置されており、感圧抵抗インク R14（導電ランド D14）と感圧抵抗インク R24（導電ランド D24）とが対向しており、Y 軸負方向に対応するように配置されている。また、感圧抵抗インク R15（導電ランド D15）と感圧抵抗インク R25（導電ランド D25）とが対向しており、Z 軸方向に対応するように配置されている。なお、上述のように対向する感圧抵抗インク（導電ランド）同士はほぼ同じ大きさを有している。

【0108】

また、センサユニット 300 では、膜状部材 370、371 の間に、導電ランド D11～D15、D21～D25 の他、回路パターン（配線）およびコネクタ端子の導電層なども形成されているが、図 13 では図示が省略されている。なお、後述するように、導電ランド D11～D15、D21～D25 は、これらの回路パターンおよび端子を通じて、センサ回路などに接続される。

【0109】

ここで、センサセル 310 では、上述したように、導電ランド D11、D21

はX軸の正方向に対応するように配置され、一方、導電ランドD12、D22はX軸の負方向に対応するように配置されており、外部からの力のX軸方向成分の検出に利用される。また、導電ランドD13、D23はY軸の正方向に対応するように配置され、一方、導電ランドD14、D24はY軸の負方向に対応するように配置され、外部からの力のY軸方向成分の検出に利用される。また、一对の導電ランドD11、D21および一对の導電ランドD12、D22は、X軸方向に離隔してY軸に対して線対称に配置されている。また、一对の導電ランドD13、D23および一对の導電ランドD14、D24は、Y軸方向に離隔してX軸に対して線対称に配置されている。

【0110】

次に、センサセル310の回路構成について、図15および図16を参照して説明する。

【0111】

センサセル310では、感圧抵抗インクR11～R15と、それらにそれぞれ対向する感圧抵抗インクR21～R25とは、可変接触抵抗R1～R5をそれぞれ構成している。従って、図15に示すように、可変接触抵抗R1、R2に接続されたR/V変換回路からそれぞれ出力された信号を例えば排他和回路や差動増幅回路などで読み取ることによって、出力V_xが導出される。同様に、可変接触抵抗R3、R4に接続されたR/V変換回路からそれぞれ出力された信号を例えば排他和回路や差動増幅回路などで読み取ることによって、出力V_yが導出され、可変接触抵抗R5および固定抵抗R6に接続されたR/V変換回路からそれぞれ出力された信号を例えば排他和回路や差動増幅回路などで読み取ることによって、出力V_zが導出される。このようにして、外部から加えられた力の方向および大きさに応じて変化する可変接触抵抗R1～R5の抵抗値に基づいて、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向に対応する出力（アナログ電圧）を得ることができる。

【0112】

図16に示すセンサセル310の回路図では、可変接触抵抗R1の一端と可変接触抵抗R2の一端とが接続されていると共に、可変接触抵抗R1の他端は電源

電圧 V_{cc} に保持されており、可変接触抵抗 R_2 の他端は接地されている。これと同様に、可変接触抵抗 R_3 の一端と可変接触抵抗 R_4 の一端とが接続されていると共に、可変接触抵抗 R_3 の他端は電源電圧 V_{cc} に保持されており、可変接触抵抗 R_4 の他端は接地されている。また、可変接触抵抗 R_5 の一端と固定抵抗 R_6 の一端とが接続されていると共に、可変接触抵抗 R_5 の他端は電源電圧 V_{cc} に保持されており、固定抵抗 R_6 の他端は接地されている。

【0113】

また、可変接触抵抗 R_1 の一端および他端には、固定抵抗 R_{10} が接続されている。同様に、可変接触抵抗 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 の一端および他端には、固定抵抗 R_{20} 、 R_{30} 、 R_{40} 、 R_{50} がそれぞれ接続されている。固定抵抗 R_{10} 、 R_{20} 、 R_{30} 、 R_{40} 、 R_{50} は、可変接触抵抗 $R_1 \sim R_5$ を構成する一对の感圧抵抗インクが離隔状態と同様の状態になって無限大の抵抗値になった場合でも、 X 軸、 Y 軸および Z 軸に対応したアナログ電圧を出力できるように設けられた一定の抵抗値を有する固定抵抗である。

【0114】

ここで、図 16 の回路図において、可変接触抵抗 R_1 と可変接触抵抗 R_2 との間の節点 X_0 からの出力 V_x と、可変接触抵抗 R_3 と可変接触抵抗 R_4 との間の節点 Y_0 からの出力 V_y と、可変接触抵抗 R_5 と固定抵抗 R_6 との間の節点 Z_0 からの出力 V_z とは、次のような式によって導出される。なお、節点 X_0 は、固定抵抗 R_{10} と固定抵抗 R_{20} との間の節点でもあって、節点 Y_0 は、固定抵抗 R_{30} と固定抵抗 R_{40} との間の節点でもあって、節点 Z_0 は、固定抵抗 R_{50} と固定抵抗 R_6 との間の節点でもある。

【0115】

【式 1】

$$V X = \frac{\frac{R2 \cdot R20}{R2+R20}}{\frac{R1 \cdot R10}{R1+R10} + \frac{R2 \cdot R20}{R2+R20}} \times V_{cc}$$

$$V Y = \frac{\frac{R4 \cdot R40}{R4+R40}}{\frac{R3 \cdot R30}{R3+R30} + \frac{R4 \cdot R40}{R4+R40}} \times V_{cc}$$

$$V Z = \frac{R6}{\frac{R5 \cdot R50}{R5+R50} + R6}$$

【0 1 1 6】

以上のように、本実施の形態に係るセンサシートにおいては、各センサセル 3 1 0 が外部から加えられた力の X 軸方向成分、Y 軸方向成分および Z 軸方向成分をそれぞれ検出することができる。従って、センサシート全体において、外部から加えられた力のカバー層 4 0 に垂直方向成分およびそれに平行な 2 方向成分を含む 3 次元の力の分布を測定することができる。従って、センサシートに作用する力の詳細な解析を行うことが可能となる。

【0 1 1 7】

また、カバー層 4 0 と支持体 3 3 0 との間には、金属製のコア 5 0 が配置されているため、外部から加えられた力を支持体 3 3 0 に効率よく伝達することができる。特に、外部から力が加えられたときの支持体 3 3 0 の傾きを利用して当該力が検出される場合、つまり、支持体 3 3 0 の X 軸正方向部分と X 軸負方向部分との変位に基づく可変接触抵抗 R 1、R 2 の各抵抗値の変化量の差を利用して当該力の X 軸方向成分が検出される場合、および、支持体 3 3 0 の Y 軸正方向部分と Y 軸負方向部分との変位に基づく可変接触抵抗 R 3、R 4 の各抵抗値の変化量の差を利用して当該力の Y 軸方向成分が検出される場合に、支持体 3 3 0 の傾き

が検出し易くなって、センサセル 3 1 0 における検出精度を向上させることができる。

【0 1 1 8】

また、本実施の形態のセンサシートにおいても、第 1 の実施の形態と同様に、マトリックス状に配置された多数のセンサセル 3 1 0 を有しており、センサセル 3 1 0 がセンサシート全体に均一に配置されているため、センサシート上に対して外部から加えられた力の分布を精度よく検出することができる。

【0 1 1 9】

また、外部から力を受けるカバー層 4 0 の表面には凹凸がなく平坦であるため、測定するための特別な条件下ではなく、通常の下条件下において力の分布を測定することができる。

【0 1 2 0】

以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて、様々な設計変更を行うことが可能なものである。例えば、上述の第 1 の実施の形態では、多数のセンサセルが平面上（平板状）に配列されたセンサシートについて説明しているが、これに限らず、多数のセンサセルが、例えば円筒状または球面状などの曲面状に配列されたセンサシートであってもよい。

【0 1 2 1】

また、上述の第 1 の実施の形態では、外部から力が加えられていない場合には、変位電極の突起部と基準電極とが離隔している場合について説明しているが、これに限らず、変位電極の突起部と基準電極とが常に接触しており、変位電極が常に接地電位に維持されていてもよい。

【0 1 2 2】

また、上述の第 1 および第 2 の実施の形態では、センサシートは、外部から加えられる力によって第 2 の電極に相当する変位電極または導電ランドを変位させるためのコア部材（コア）を有している場合について説明しているが、必ずしもコア部材はなくてもよい。また、コア部材と共にカバー層も配置されていなくてもよく、変位電極または支持体が直接外部から加えられる力を受けてもよい。こ

の場合に、変位電極または支持体の表面が凹凸がなく平坦になるように形成されていてもよい。

【0 1 2 3】

また、上述の第 1 および第 2 の実施の形態では、センサシートには、多数のセンサセルがマトリックス状に配置されている場合について説明しているが、これに限らず、多数のセンサシートの配置は任意に変更することができる。

【0 1 2 4】

また、上述の第 1 および第 2 の実施の形態では、外部から加えられる力について互いに異なる 3 つの方向の対応する成分を認識可能なセンサを含むセンサシートについて説明しているが、これに限らず、センサシートに含まれるセンサとしては、当該力について互いに異なる 2 つの方向に対応する成分を認識可能なものであってもよい。

【0 1 2 5】

また、上述の第 1 および第 2 の実施の形態では、センサシートに含まれるセンサセルが静電容量式センサまたは抵抗型センサのいずれかを含んでいる場合について説明しているが、これに限らず、本実施の形態と同様の機能を有するセンサ（センサセル）であれば、その他の種類のセンサであってもよい。

【0 1 2 6】

また、上述の第 1 の実施の形態では、E X - O R 素子が含まれる信号処理回路が用いられる場合について説明しているが、これに限らず、信号処理回路の構成は任意に変更することができる。従って、排他的論理和演算を行う E X - O R 素子の代わりに、論理和演算を行う O R 素子、論理積演算を行う A N D 素子、論理積演算および否定演算を行う N A N D 素子のいずれかが含まれる信号処理回路が用いられてもよい。この場合には、センサセルの各部材が感度が非常によくなる材料で製作された場合に、信号処理回路の構成によって、センサシートの感度を調節する（ここでは、感度を低下させる）ことができる。

【0 1 2 7】

【発明の効果】

以上説明したように、請求項 1、2、4 によると、センサが外部から加えられ

た力の複数方向成分をそれぞれ認識することができるため、センサシート全体において、外部から加えられた力の検知面に垂直方向成分だけでなく、その他の方向成分を含む多次元の力の分布を測定することができる。従って、センサシートに作用する力の詳細な解析を行うことが可能となる。

【0 1 2 8】

請求項3によると、外部から力が加えられていない場合には、第2の電極が絶縁状態に維持されているため、第1の電極と第2の電極との間に構成される容量素子には電圧がかからない。そのため、当該容量素子に蓄えられている電荷量が無視できる程度に小さくなり、センサからの出力信号は一定の大きさに安定している。一方、外部から力が加えられると、第2の電極が接地された第3の電極と接触するため、当該容量素子に電圧がかかるようになる。そのため、当該容量素子に蓄えられている電荷量が急激に大きくなり、センサからの出力信号が当該容量素子の静電容量値の変化に応じて大きく変化する。このように、外部から力が加えられる前およびその後における当該容量素子に蓄えられている電荷量は、外部から力が加えられている間の電荷量と比較すると、いずれも無視できる程度に小さい。そのため、第2の電極の復帰位置が元の位置からずれた場合でも、外部から力が加えられる前およびその後におけるセンサの各容量素子に対応する（各容量素子用電極からの）出力信号はほとんど同じになる。これにより、センサの各容量素子に対応する出力信号のヒステリシスを低減することができる。

【0 1 2 9】

また、第2の電極と第3の電極とが互いに接触する状態および接触しない状態のいずれかの状態を取りうるスイッチとして機能するため、外部から力が加えられていないセンサの第2の電極が、当該センサに近接するその他のセンサに対して外部から加えられた力によって若干（当該センサの第2の電極と第3の電極とが接触しない程度に）変位した場合でも、当該センサの出力が変化することがない。従って、当該センサに近接するその他のセンサに加えられる力によって、当該センサに測定誤差が生じて、力の分布の測定精度が著しく低下するのを抑制することができる。つまり、複数のセンサが互いに近接するように配置されている場合でも、所定の大きさ（第2の電極と第3の電極とを接触させる程度の大きさ

）以上の力が加えられたセンサだけが力覚センサとして機能することになる。

【0130】

請求項5によると、外部から加えられた力を第2の電極に効率よく伝達することができる。特に、外部から力が加えられたときの第2の電極の傾き（第2の電極の一端部の変位と他端部の変位との差）を利用して当該力が検出される場合に、第2の電極の傾きが検出し易くなって、センサにおける検出精度を向上させることができる。

【0131】

請求項6によると、センサがセンサシート全体に均一に配置されるため、センサシート上に対して外部から加えられた力の分布を精度よく検出することができる。

【0132】

請求項7によると、外部から力を受ける面には凹凸がなく平坦であるため、測定するための特別な条件下ではなく、通常の条件下において力の分布を測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態に係るセンサシートの斜視図である。

【図2】

図1のセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。

【図3】

図2のセンサセルの基板上に形成されている複数の電極の配置を示す図である。

【図4】

図2に示すセンサセルの構成に対する等価回路図である。

【図5】

図2に示すセンサセルに対して外部から力が加えられた場合の側面の模式的な断面図である。

【図 6】

図 2 に示すセンサセルに入力される周期信号から出力信号を導出する方法を説明するための説明図である。

【図 7】

図 2 に示すセンサセルの信号処理回路を示す回路図である。

【図 8】

図 2 に示すセンサセルの X 軸方向成分についての信号処理回路を示す回路図である。

【図 9】

図 8 に示す信号処理回路の各端子および各節点における周期信号の波形を示す図である。

【図 10】

本実施の形態の第 1 の変形例のセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。

【図 11】

本実施の形態の第 2 の変形例のセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。

【図 12】

図 11 のセンサセルの基板上に形成されている複数の電極の配置を示す図である。

【図 13】

本発明の第 2 の実施の形態に係るセンサシートに含まれるセンサセルの模式的な断面図である。

【図 14】

図 13 のセンサセルに含まれる複数の電極の配置を示す図である。

【図 15】

図 13 に示すセンサセルの回路の概略構成図である。

【図 16】

図 13 に示すセンサセルの回路図の一例である。

【符号の説明】

1 センサシート

1 0、1 1 0、2 1 0、3 1 0 センサセル（センサ）

3 0 変位電極（第 2 の電極）

5 0 コア（コア部材）

D 0 基準電極（第 3 の電極）

D 1 ～ D 5 容量素子用電極（第 1 の電極）

D 1 1 ～ D 1 5 導電ランド（第 1 の電極）

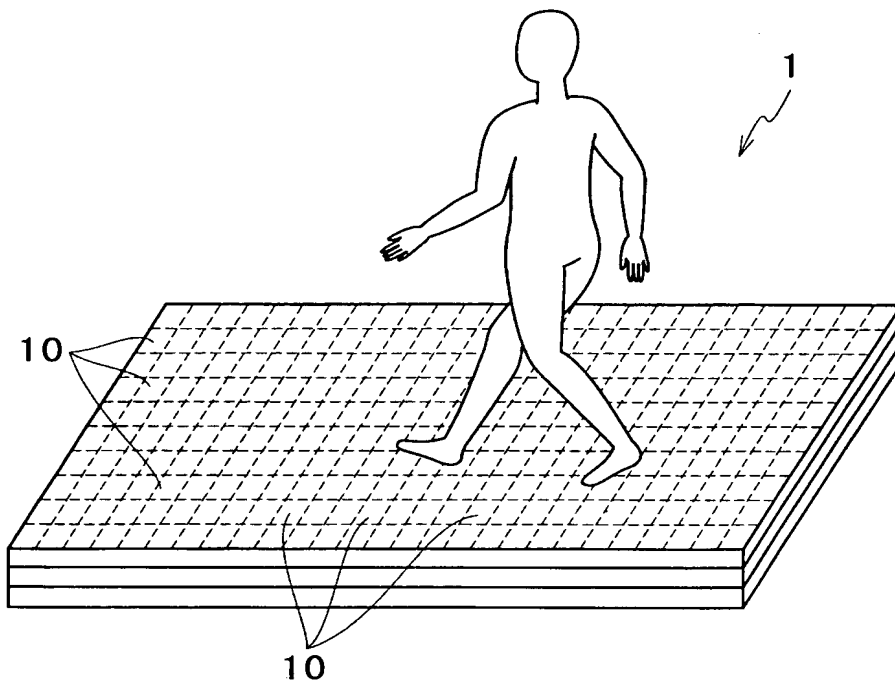
D 2 1 ～ D 2 5 導電ランド（第 2 の電極）

R 1 1 ～ R 1 5、R 2 1 ～ R 2 5 感圧抵抗インク（感圧抵抗体）

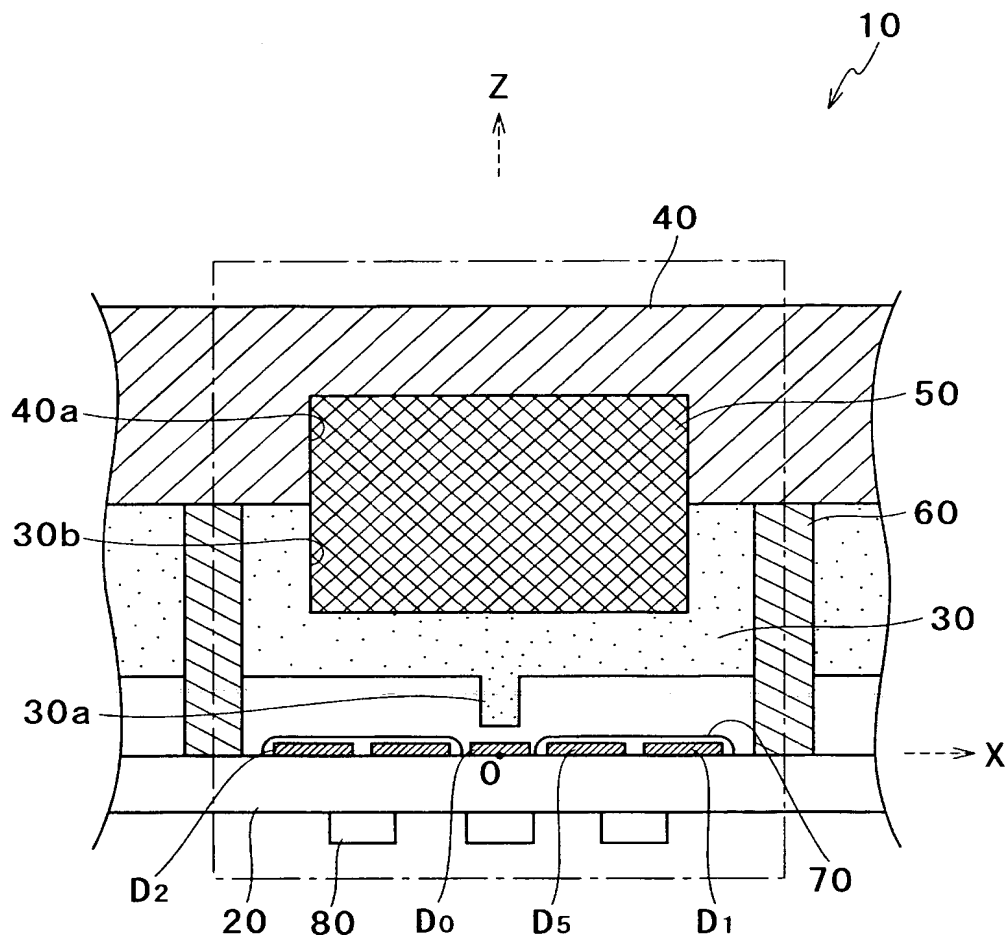
C 1 ～ C 4 容量素子

【書類名】 図面

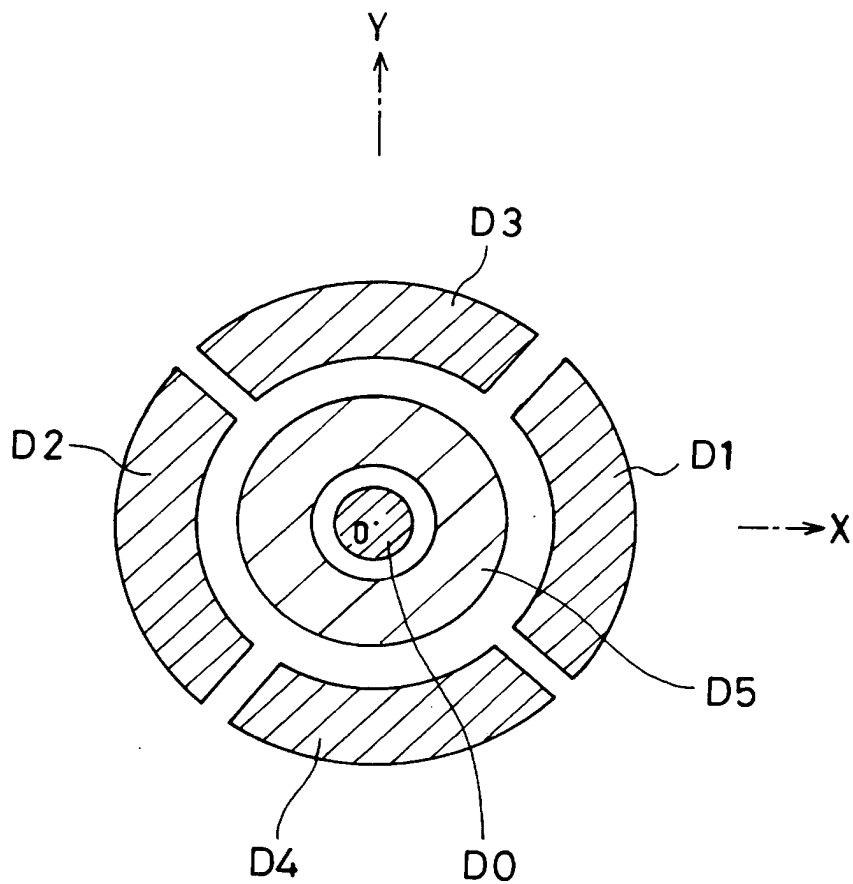
【図 1】



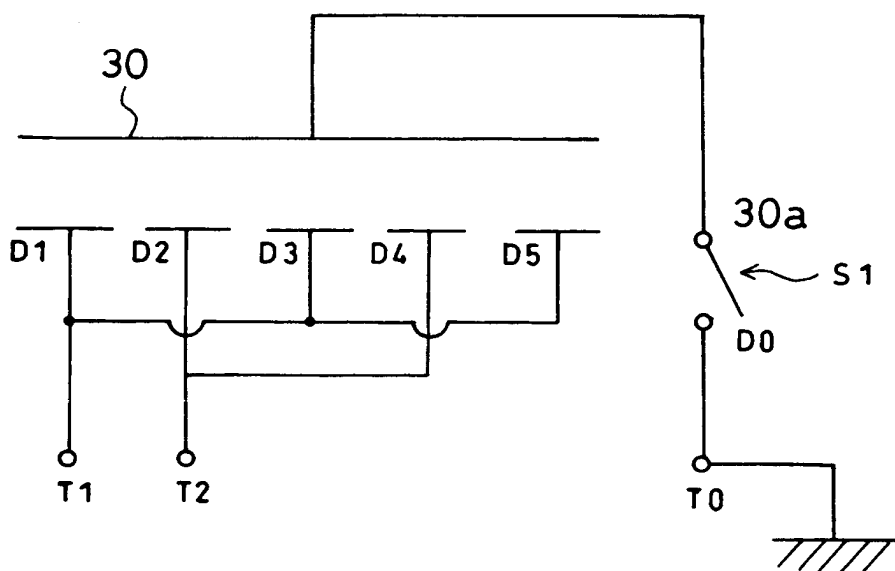
【図 2】



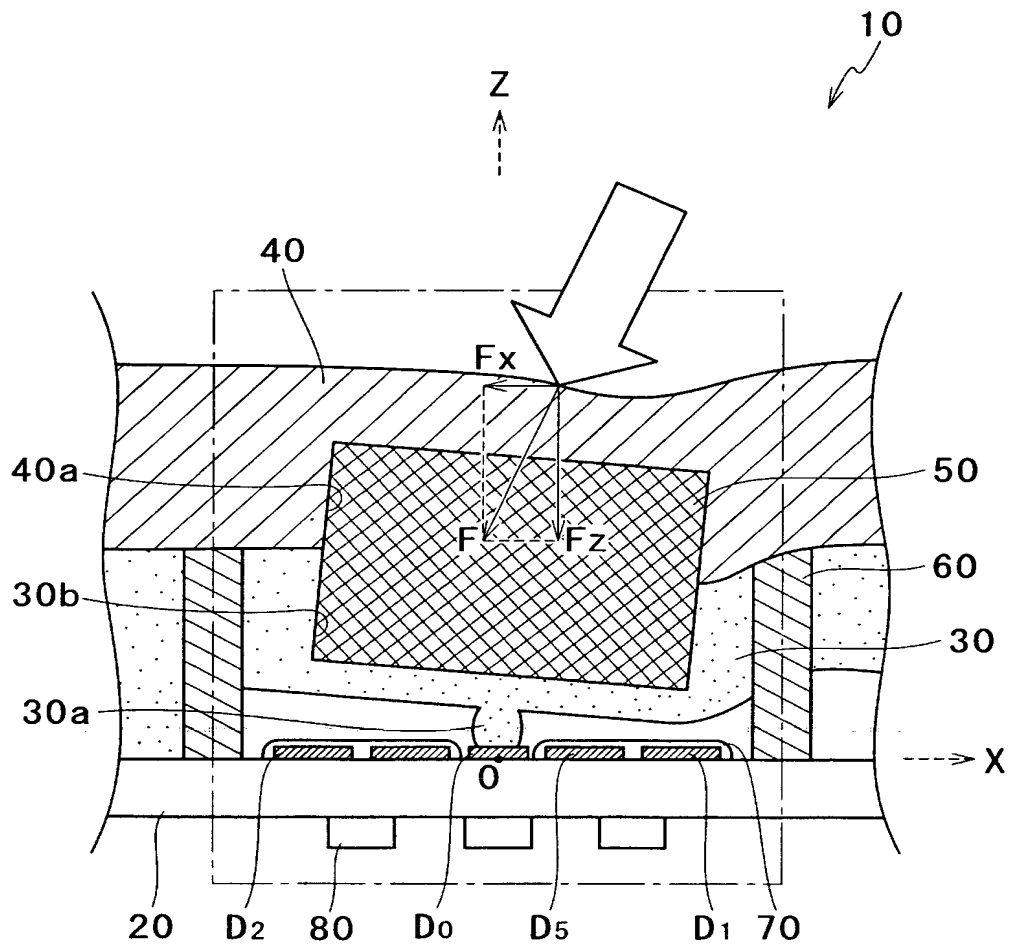
【図 3】



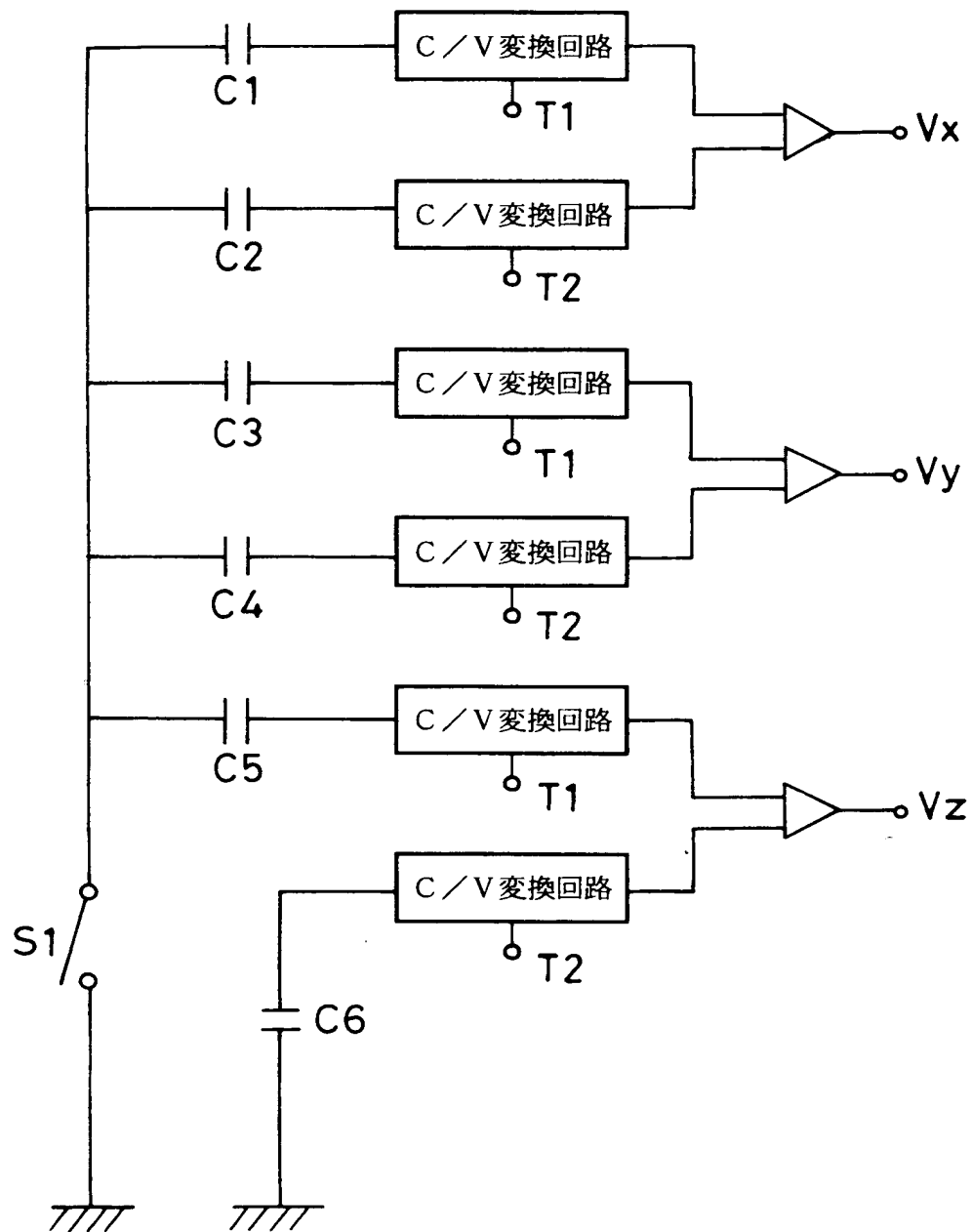
【図 4】



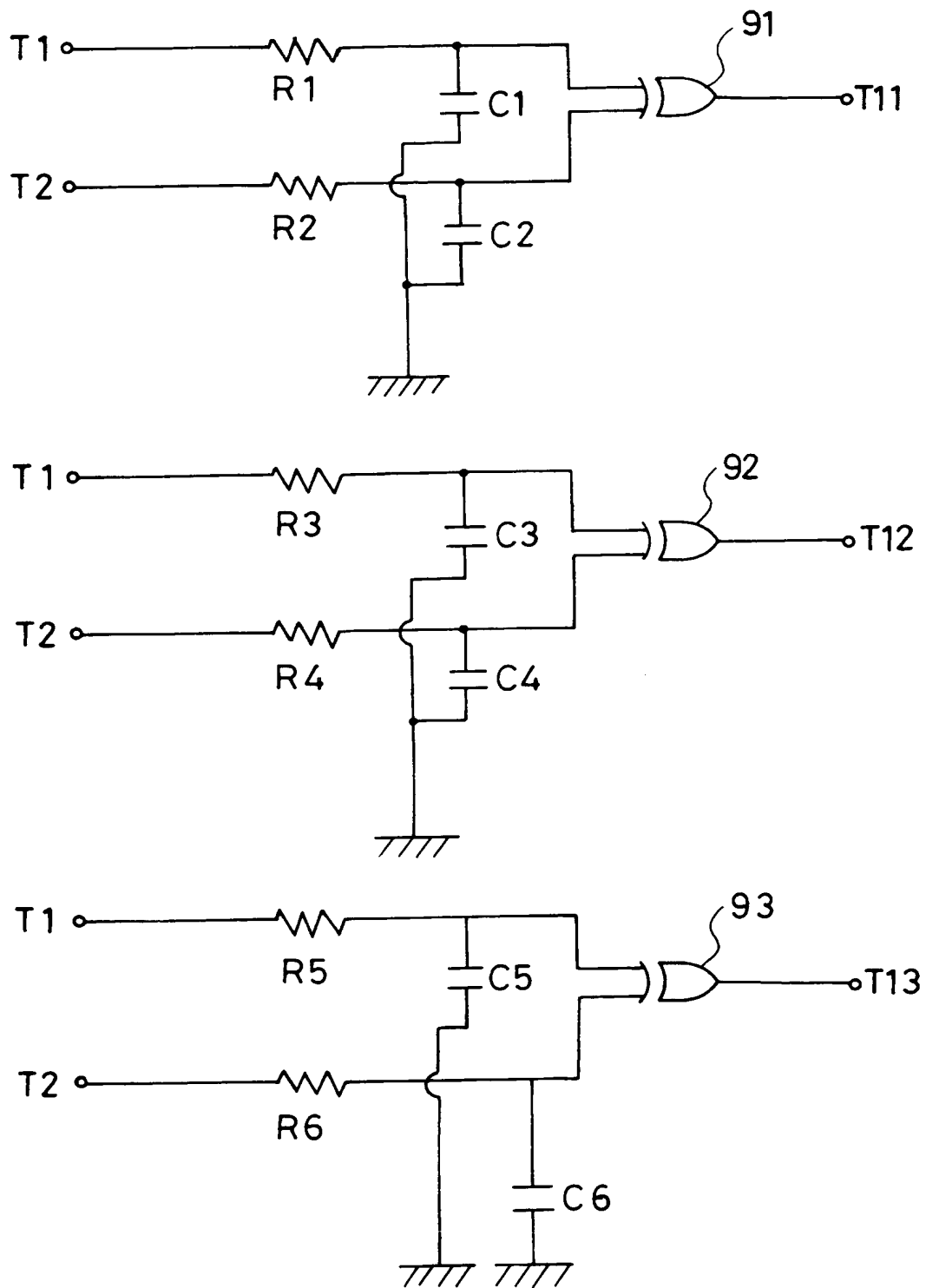
【図 5】



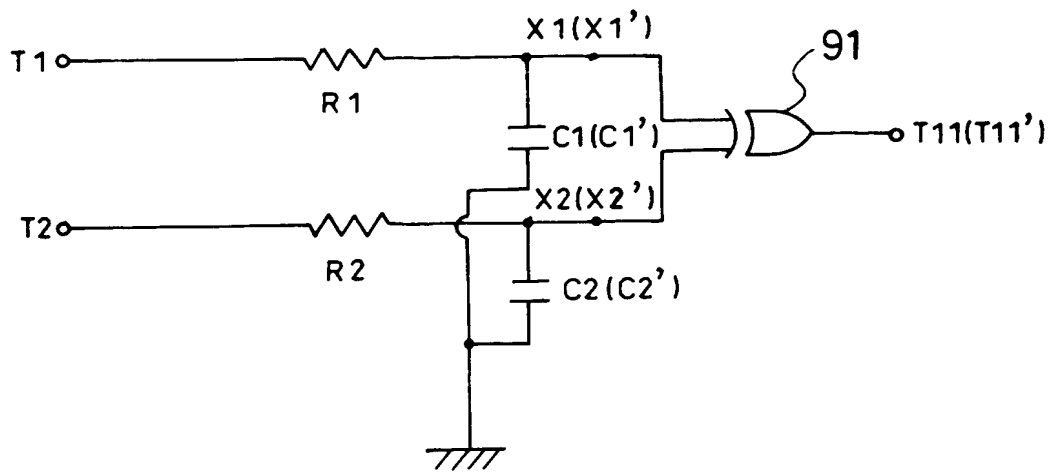
【図 6】



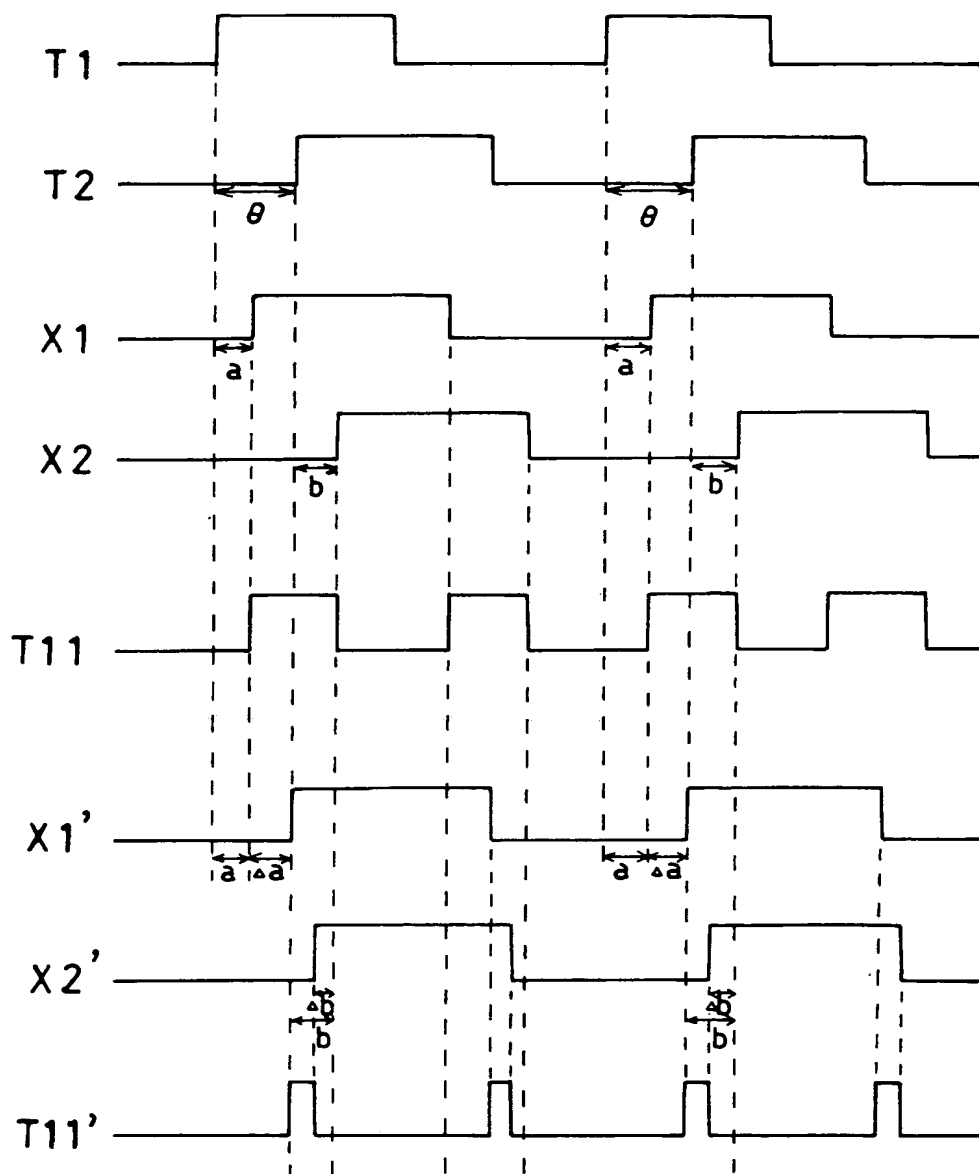
【図 7】



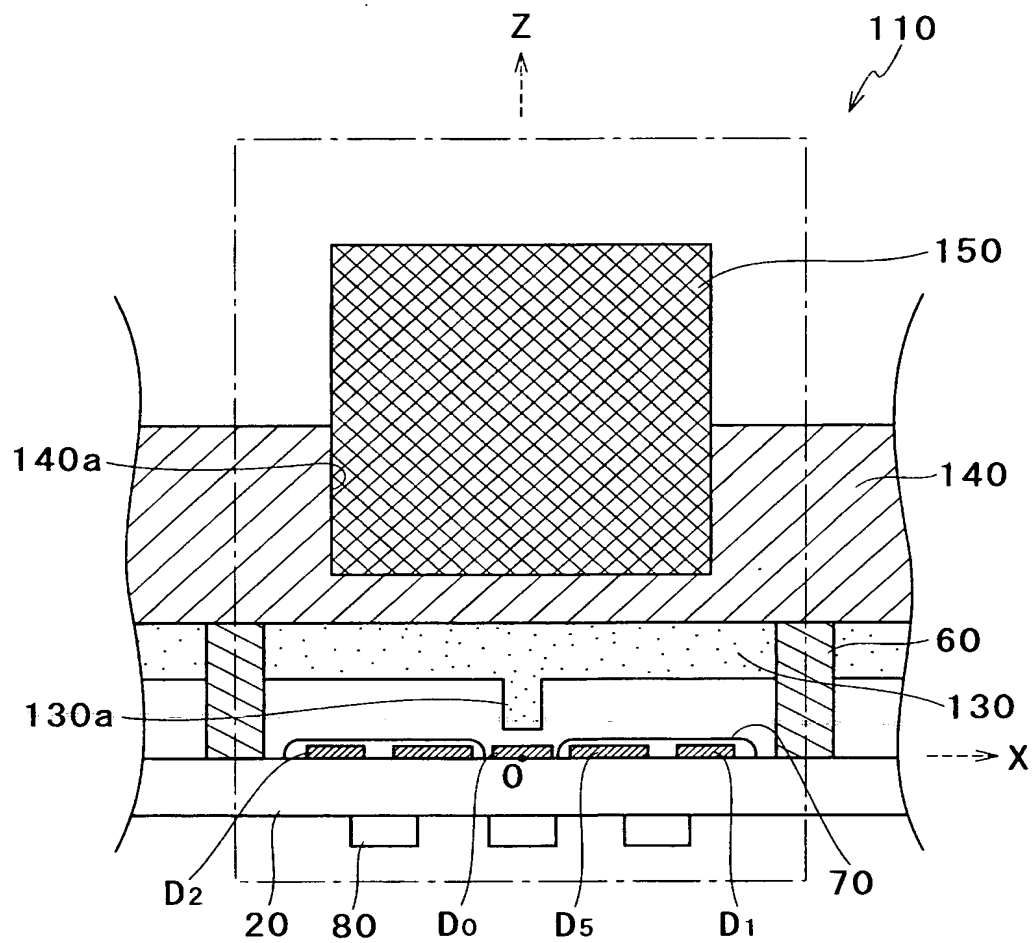
【図 8】



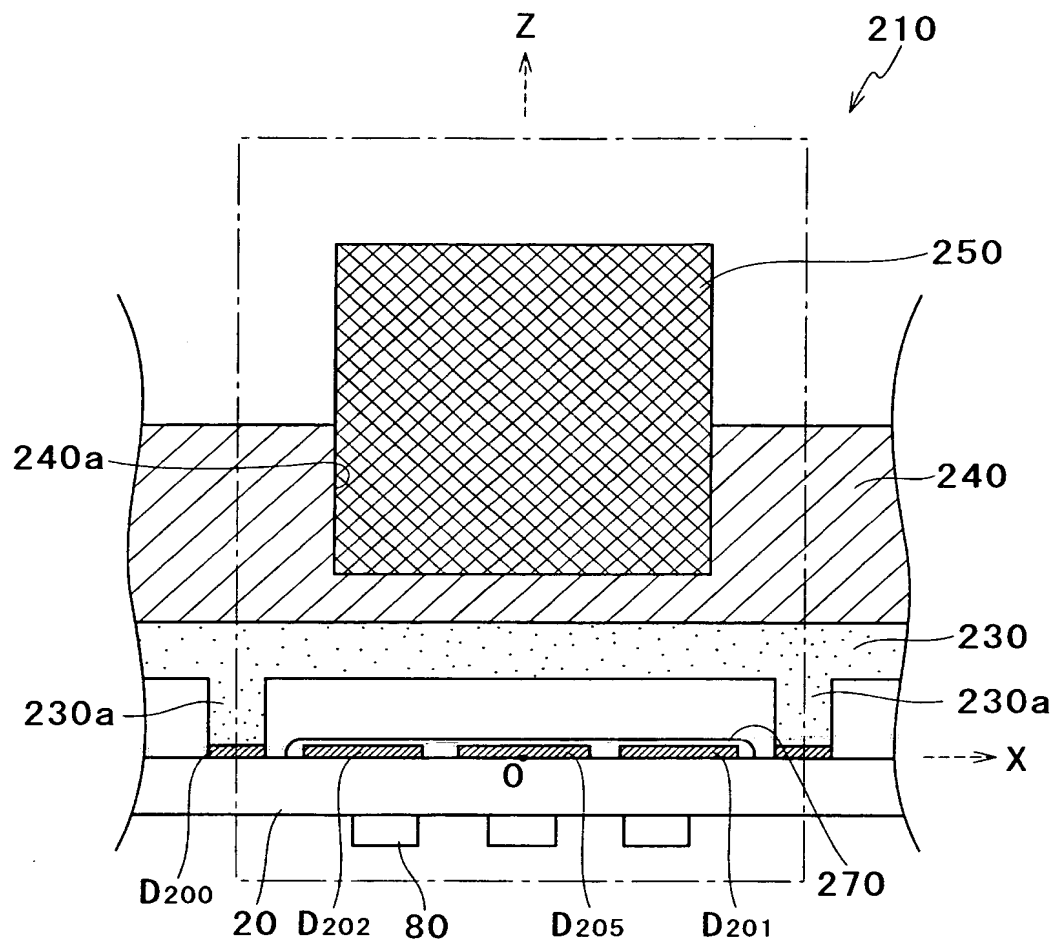
【図 9】



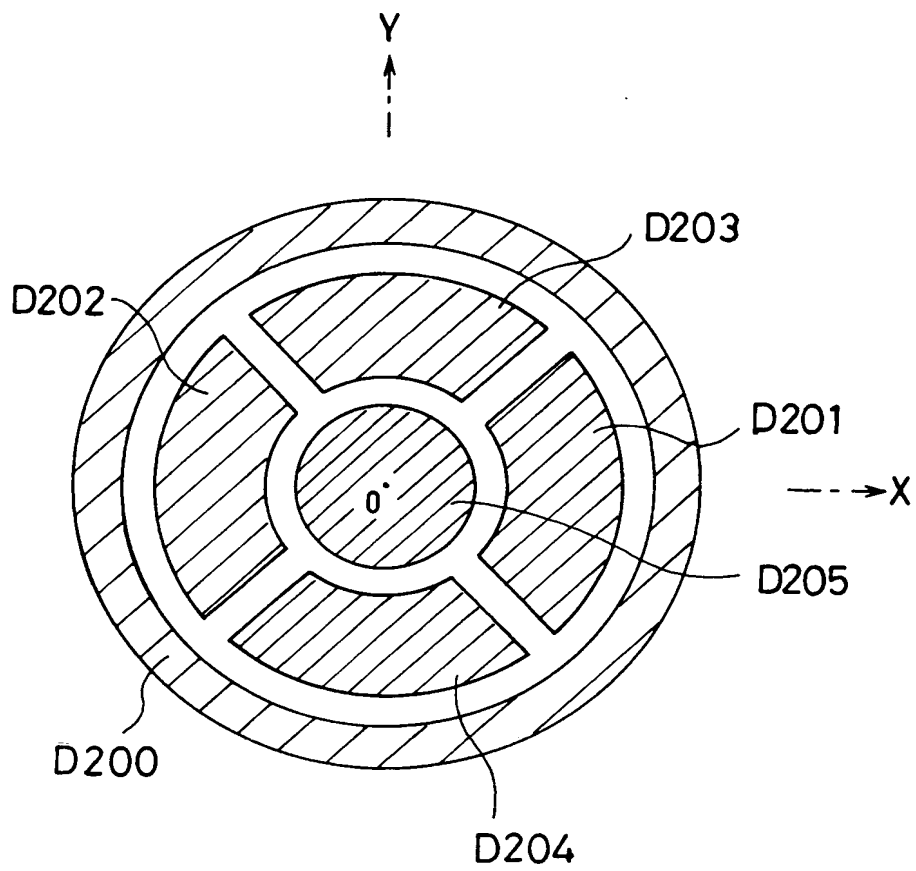
【図 10】



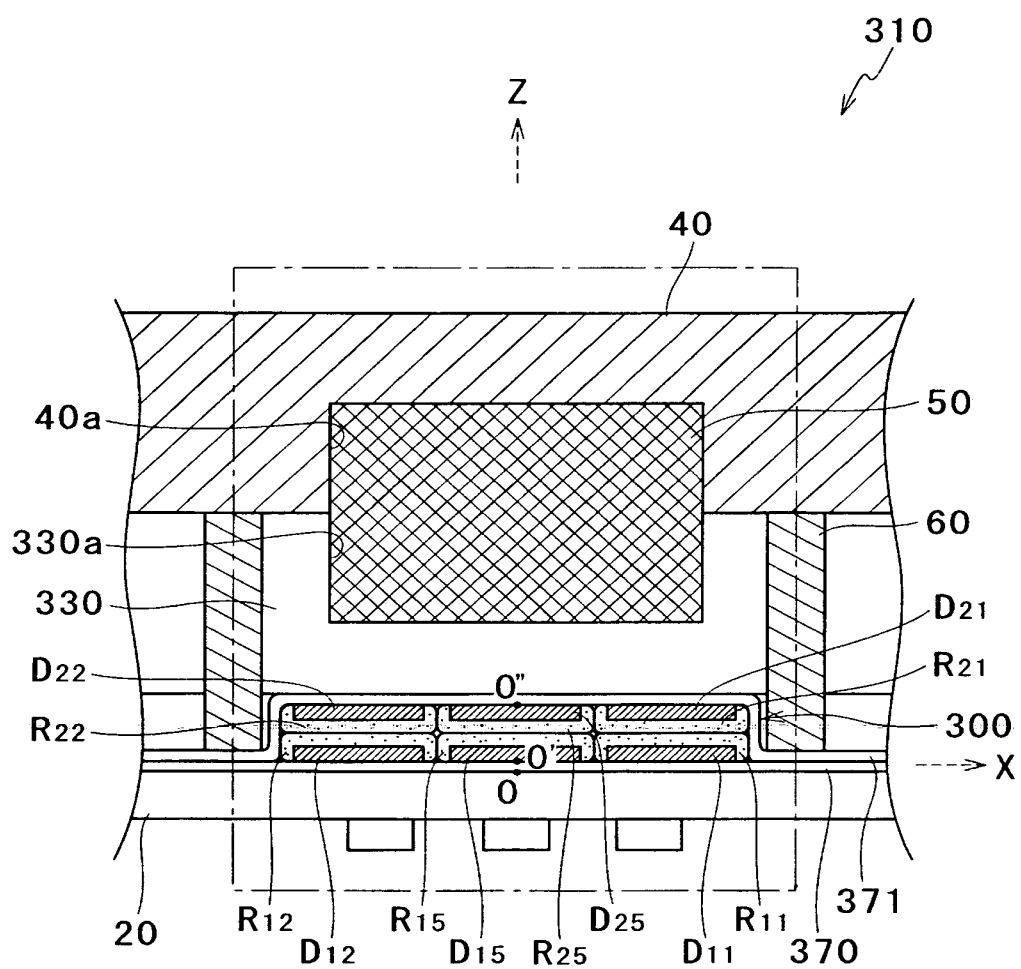
【図 11】



【図 1 2】

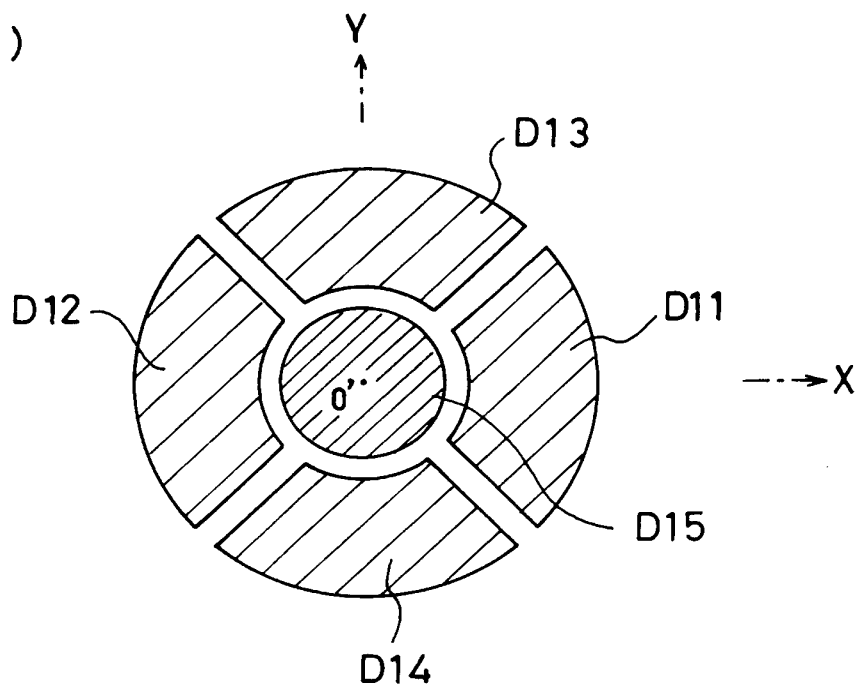


【図 13】

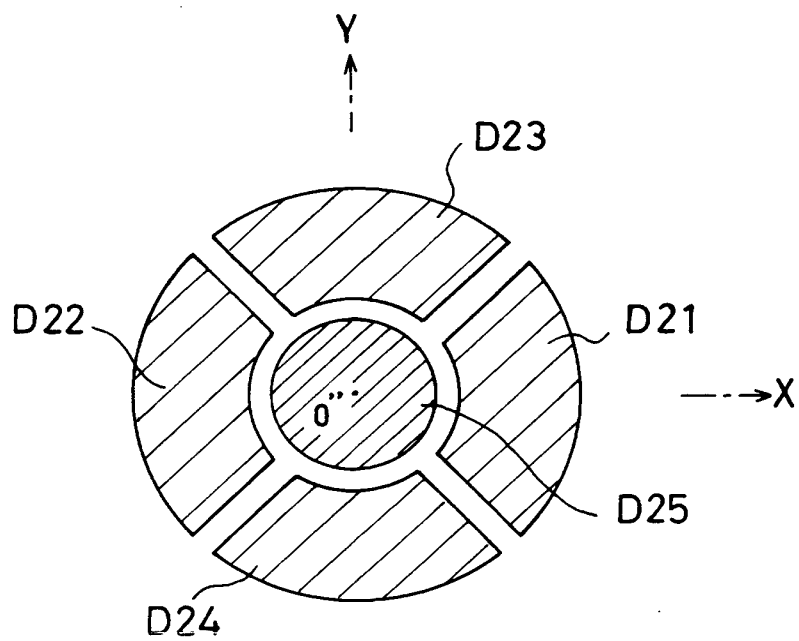


【図 14】

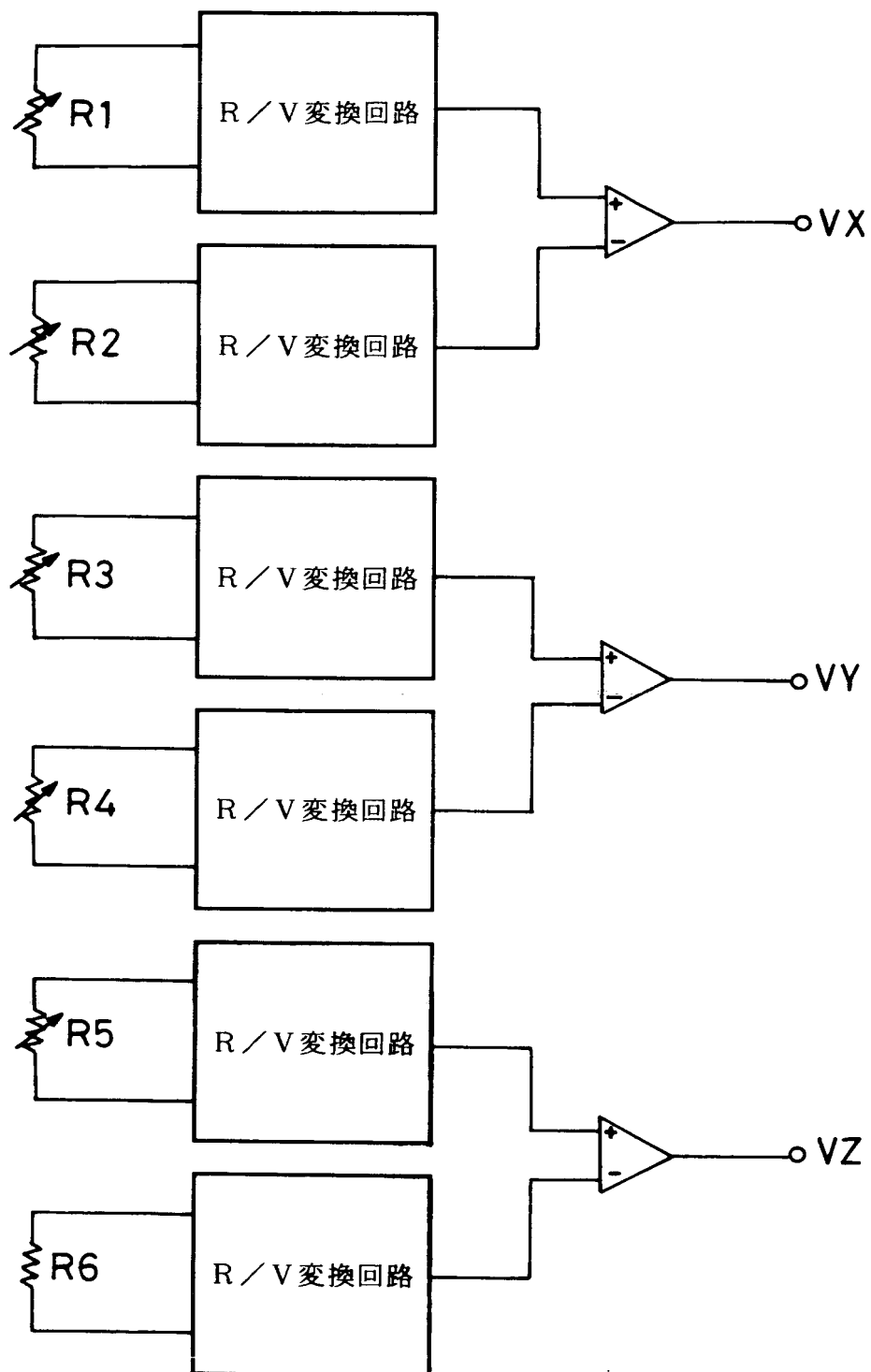
(a)



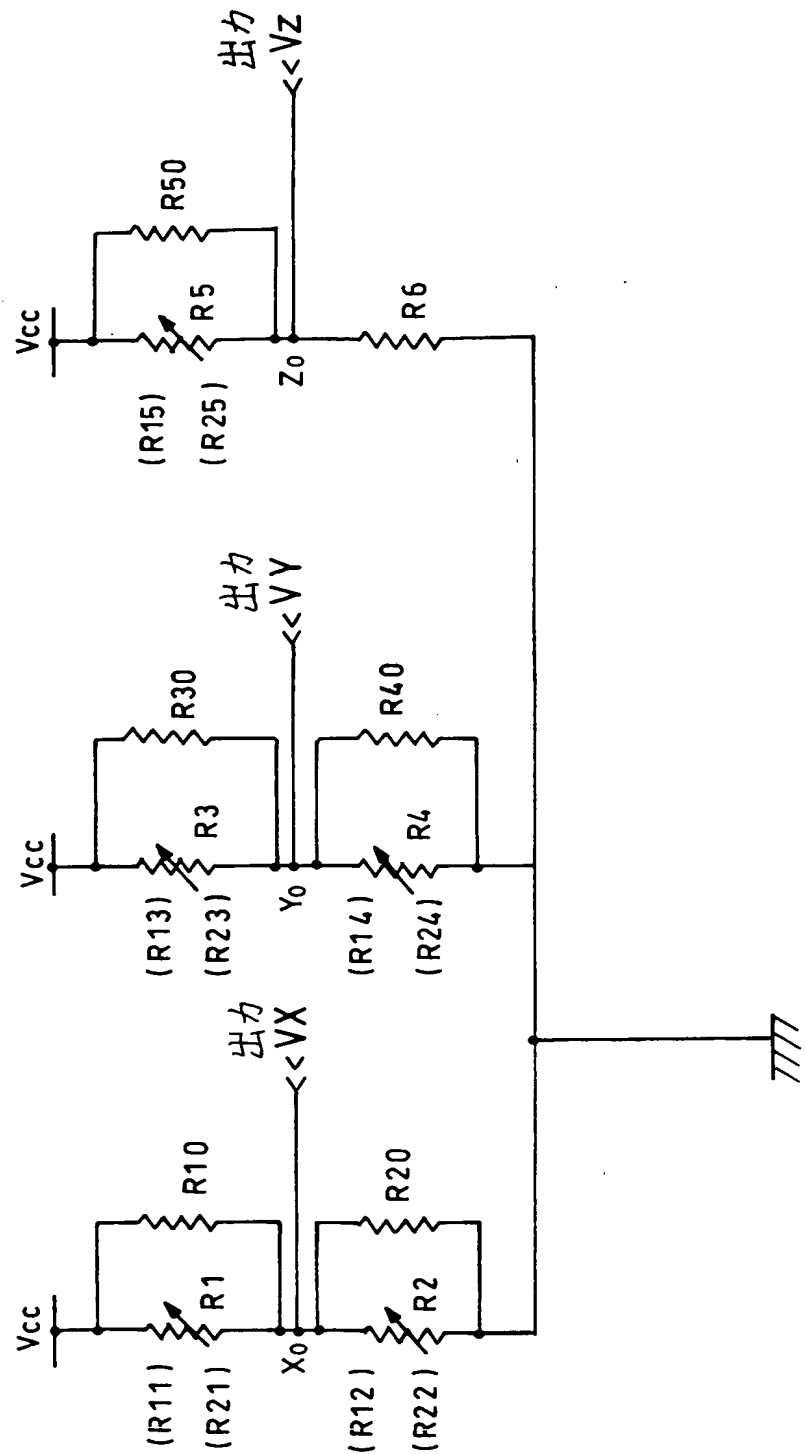
(b)



【図 15】



【図 1 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 センサシートにより多次元の力の分布を測定する。

【解決手段】 X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向にそれぞれ対応する容量素子用電極D 1～D 5と、これらとの間にそれぞれ容量素子が構成されるように配置された変位電極3 0とを有する多数のセンサセル1 0をマトリックス状に配置する。これにより、多数のセンサセル1 0のそれぞれにおいて検出された力の各成分に基づいて、センサシート全体として、外部から加えられた力の3次元的な分布を測定することが可能となる。

【選択図】 図 2



特願 2 0 0 2 - 2 7 7 6 2 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 1 1 0 8 5]

1. 変更年月日

1 9 9 8 年 3 月 3 0 日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪市浪速区桜川 4 丁目 4 番 2 6 号

氏 名

ニッタ株式会社

2. 変更年月日

2 0 0 2 年 2 月 2 1 日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府大阪市浪速区桜川 4 丁目 4 番 2 6 号

氏 名

ニッタ株式会社